

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

M-5599 US
9-8207

substantially equal to a semiconductor chip in a dimension in X and Y directions except in a direction of thickness. The resin-encapsulated semiconductor device in accordance with the present invention means a semiconductor device employing a lead frame among the defined CSP type 5 semiconductor device.

In the CSP type semiconductor device described above, the terminal portions made of solder are formed on each of the terminal columns and is externally exposed from the encapsulating resin, but the terminal portions do not necessarily need to be protruded from the encapsulating resin. Moreover, if necessary, the outside face of each terminal column which is exposed externally from the encapsulating resin may be covered with a protective frame 10 15 by means of an adhesive.

(FUNCTIONS)

The resin-encapsulated semiconductor device in accordance with the present invention can meet a demand for 20 an increase in the number of terminals and has a miniaturized structure and thus an increased mounting efficiency. At this time, in the resin-encapsulated semiconductor device, as the removal process of the dam bars by press working or the forming process of the outer 25 leads as in the case of using a mono-layered lead frame

shown in Fig. 11b is not required, there is no problem such as bending or coplanarity of the outer leads due to this process. More particularly, the use of a multipinned lead frame shaped in a manner that inner leads have a thickness smaller than that of the lead frame blank by a two-step etching process, that is, the inner leads are arranged at a fine pitch, can meet a demand for an increase in the pin number of the semiconductor device. Moreover, as the resin-encapsulated semiconductor device is fabricated in such a manner that it is equal to that of a semiconductor chip in size, it can be miniaturized. In addition, each of the inner leads fabricated by a two-step etching process as shown Fig. 8 has a rectangular cross-sectional shape including four faces respectively provided with a first surface, a second surface, a third surface, and a fourth surface, the first surface being opposite to the second surface and flush with one surface of the remaining portion of the inner lead having the same thickness as that of the lead frame blank, and the third and fourth surfaces each having a concave shape depressed toward the inside of the inner lead. Thus, the second surface of each inner lead is flat, and is excellent in wire-bonding property. Moreover, as the first surface of each inner lead is flat and the third and fourth surfaces of the inner leads each have a concave shape depressed toward the inside of the inner

(19)日本特許庁 (JP)

(11)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公報番号

特開平9-8207

(43)公開日 平成9年(1997)1月10日

(51) (a), (c),	並列記号	序内登録番号	F1	技術表示箇所
NOIL 23/50			NOIL 23/50	1
21/60	301		21/60	2
23/28			23/28	3

審査請求 取扱い 請求項の数6 FD (全15頁)

(21)出願番号 特願平7-176898
 (22)出願日 平成7年(1995)6月21日

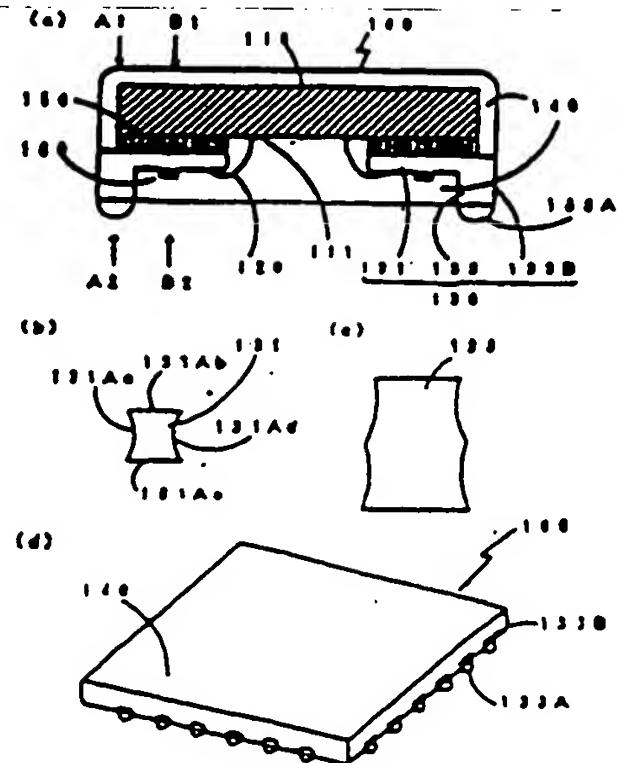
(71)出願人 000002897
 大日本印刷株式会社
 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
 (72)発明者 山田 保一
 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
 大日本印刷株式会社内
 (73)発明者 佐々木 貴
 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
 大日本印刷株式会社内
 (74)代理人 弁護士 小西 邦美

(34)【発明の名称】断路対止型半導体装置

(57)【要約】

【目的】リードフレームを用いた断路対止型半導体装置であって、多端子化に対応させて実装性の良いものを提供する。

【構成】2段エッティング加工によりインナーリード部の厚さがリードフレーム底材の厚さよりも薄肉に外筋加工されたリードフレームを用い、且つ、外筋や底をほぼ半導体素子に合わせた、断路用断路により断路対止したCSP (CHIP SIZE Package) 型の半導体装置であって、断路リードフレームは、底面のインナーリード部と、底インナーリード部に対し、インナーリード部の外部側の端部においてインナーリードに嵌合する方向で、半導体素子基板と反対側に一側的に置いた。外筋側と接続するための電子柱を有するもので、該電子柱の外部側の面に半導体からなる電子柱を設け、電子柱を対止用断路部から突出させている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 2段エッチング加工によりインナーリードの厚さがリードフレーム素材の厚さよりも薄間に外周加工されたリードフレームを用い、外周寸法をほぼ半導体電子に合わせて封止用樹脂により樹脂封止したCSP (Chip Size Package) 型の半導体装置であって、前記リードフレームは、リードフレーム素材よりも薄肉のインナーリードと、はインナーリードに一体的に形成したリードフレーム素材と同じ厚さの外部樹脂とは反対するための柱状の電子柱とを有し、且つ、電子柱はインナーリードの外部側においてインナーリードに対して厚み方向に直交し、かつ半導体電子部材部と反対側に抜けられており、電子柱の先端面に半球等からなる電子部を抜け、電子部を封止用樹脂部から露出させ、電子柱の外部側の樹脂を封止用樹脂部から露出させており、半導体電子は、半導体電子の電極部を有する面にて、インナーリード部に絶縁性樹脂を介して固定されており、エミッタ部子の電極部はインナーリード間に抜けられ、半導体電子部材部とは反対側のインナーリード先端部とワイヤにて電気的に接続されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

【請求項2】 2段エッチング加工によりインナーリードの厚さがリードフレーム素材の厚さよりも薄肉に外周加工されたリードフレームを用い、外周寸法をほぼ半導体電子に合わせて封止用樹脂により樹脂封止したCSP (Chip Size Package) 型の半導体装置であって、前記リードフレームは、リードフレーム素材よりも薄肉のインナーリードと、はインナーリードに一体的に形成したリードフレーム素材と同じ厚さの外部樹脂とは反対するための柱状の電子柱とを有し、且つ、電子柱はインナーリードの外部側においてインナーリードに対して厚み方向に直交し、かつ半導体電子部材部と反対側に抜けられており、電子柱の先端面の一部を封止用樹脂部から露出させて電子部とし、電子柱の外部側の樹脂を封止用樹脂部から露出させており、半導体電子は、半導体電子の一部に抜けられたパンプを介してインナーリード部に固定され、半導体電子とインナーリード部とが電気的に接続していることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

【請求項3】 〔請求項1ないし2において、〕インナーリードは、該電子柱が該方端で第1面、第2面、第3面、第4面の4面を有しており、かつ第1面はリードフレーム素材と同じ厚さの他の部分の一方の面と同一平面上にあって第2面に向をもっており、第3面、第4面はインナーリードの内部に向かって凹んだ形状に形成されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

【請求項4】 2段エッチング加工によりインナーリードの厚さがリードフレーム素材の厚さよりも薄肉に外周加工されたリードフレームを用い、外周寸法をほぼ半導体電子に合わせて封止用樹脂により樹脂封止したCSP (Chip Size Package) 型の半導体装置であって、前記リードフレームは、リードフレーム素材

よりし厚肉のインナーリードと、はインナーリードに一体的に形成したリードフレーム素材と同じ厚さの外部樹脂部と封止するための柱状の電子柱とを有し、且つ、電子柱はインナーリードの外部側においてインナーリードに対して厚み方向に直交し、かつ半導体電子部材部と反対側に抜けられており、電子柱の先端面に半球等からなる電子部を抜け、電子部を封止用樹脂部から露出させ、電子柱の外部側の樹脂を封止用樹脂部から露出させており、半導体電子は、半導体電子の一部に抜けられたパンプを介してインナーリード部に固定され、半導体電子とインナーリード部とが電気的に接続していることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

【請求項5】 2段エッチング加工によりインナーリードの厚さがリードフレーム素材の厚さよりも薄肉に外周加工されたリードフレームを用い、外周寸法をほぼ半導体電子に合わせて封止用樹脂により樹脂封止したCSP (Chip Size Package) 型の半導体装置であって、前記リードフレームは、リードフレーム素材よりも薄肉のインナーリードと、はインナーリードに一体的に形成したリードフレーム素材と同じ厚さの外部樹脂とは反対するための柱状の電子柱とを有し、且つ、電子柱はインナーリードの外部側においてインナーリードに対して厚み方向に直交し、かつ半導体電子部材部と反対側に抜けられており、電子柱の先端の一部を封止用樹脂部から露出させて電子部とし、電子柱の外部側の樹脂を封止用樹脂部から露出させており、半導体電子は、半導体電子の一部に抜けられたパンプを介してインナーリード部に固定され、半導体電子とインナーリード部とが電気的に接続していることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

【請求項6】 〔請求項1ないし5において、〕インナーリードは、該電子柱が該方端で第1面、第2面、第3面、第4面の4面を有しており、かつ第1面はリードフレーム素材と同じ厚さの他の部分の一方の面と同一平面上にあって第2面に向をもっており、第3面、第4面はインナーリードの内部に向かって凹んだ形状に形成されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

〔発明の詳細な説明〕

〔0001〕

〔最良上の利用分野〕 本発明は、半導体装置の多端子化に対応させ、且つ、半導体の良い小型化が可能な樹脂封止型半導体装置に焦点を当てるので、特に、エッチング加工により、インナーリード部をリードフレーム素材の厚さよりも薄肉に外周加工したリードフレームを用いた樹脂封止型半導体装置に該する。

〔0002〕

〔従来の技術〕 既により用いられている樹脂封止型の半導体装置(プラスチックリードフレームパッケージ)は、一概に図11(4)に示されるような構造であり、半導体素子120を封止するダイパッド部1111や

周囲の回路との電気的接続を行うためのアワーリード 1113、アワーリード部 1113 に一体となったインナーリード部 1112、並インナーリード部 1112 の先端部と半導体素子 1120 の電極パッド 1121 とを電気的に接続するためのワイヤ 1130、半導体素子 1120 を封止して外界からの応力、熱熱から守る封止部 1140 等からなっており、半導体素子 1120 をリードフレームのダイパッド 1111 等に接続した後に、封止部 1140 により封止してパッケージとしたもので、半導体素子 1120 の電極パッド 1121 に接続できる数のインナーリード 1112 を必要とするものである。そして、このような封止部の半導体装置の封止部材として用いられる（既発）リードフレームは、一般には図 11 (b) に示すような構造のもので、半導体素子を封止するためのダイパッド 1111 と、ダイパッド 1111 の周囲に付けられた半導体素子と接続するためのインナーリード 1112、並インナーリード 1112 に遮蔽して外露回路との接続を行うためのアワーリード 1113、封止部封止部材のダムとなるダムバー 1114、リードフレーム 1110 全体を支撐するアーチ (a) 部 1115 等を備えており、通常、コバルト、42 合金 (42%ニッケル-48%鉄)、銅錫合金のような導電性に優れた金属を用い、プレス性もしくはエッチング性により形成されていた。

(0003) このようなリードフレームを利用した封止部の半導体装置（プラスチックリードフレームパッケージ）においても、電子機器の機能性小化の特徴と半導体素子の高集成化にはい、小型表面化かつ電極端子の増大化が顕著で、その結果、封止部半導体装置、特に QFP (Quad Flat Package) 及び TQFP (Thin Quad Flat Package) 等では、リードの多ビン化がさしくなってきた。上記の半導体装置に用いられるリードフレームは、貴重なものはフォトリソグラフィー技術を用いたエッチング加工方法により作成され、貴重でないものはプレスによる加工方法による作成されるのが一般的であったが、このような半導体装置の多ビン化にはい、リードフレームにおいても、インナーリード部先端の複雑化が進み、そのため、貴重なものに対しては、プレスによるリード引抜き工によらず、リードフレーム部材の板厚が 0.25 mm 程度のものを用い、エッチング加工で対応してきた。このエッチング加工方法の工法について以下、図 10 に基づいて簡単に述べておく。先ず、既述もしくは 42% ニッケル-48% 鉄合金からなる厚さ 0.25 mm 程度の板材（リードフレーム素材 1010）を十分洗浄（図 10 (a)）した後、重クロム酸カリウムを含む酸とした水溶液カゼインレジスト等のフォトレジスト 1020 を基板の露出した部に一気に塗布する。（図 10 (b)）次いで、所定のパターンが形成されたマスクを介して基板上でレジスト膜を形成した後、所定の露印量では

感光性レジストを現出して（図 10 (c)），レジストバーン 1030 を形成し、段階露印、焼却處理等を必要に応じて行い、塩化第二鉛水溶液を三たる反応槽にてエッチング液にて、スプレイにて基板（リードフレーム素材 1010）に吹きかけ所定の形状形成にエッチングし、露印させる。（図 10 (d)）

次いで、レジスト膜を焼却處理し（図 10 (e)），既露印、所定のリードフレームをはて、エッチング加工液を吹きかけた。このように、エッチング加工液によって作成されたリードフレームは、更に、所定のエリアに露印キズ等が残される。次いで、焼却、焼却等の処理を経て、インナーリード部を固定用の接着剤付セボリイミドテープにてテーピング処理したり、必要に応じて所定の量タブホリバーを曲げ加工し、ダイパッド部をダフンセットする処理を行う。しかし、エッチング加工方法においては、エッチング液による露印は該加工板の板厚方向の端に板厚（既）方向にも達したため、その既露化加工にも露印があるのが一般的で、図 10 に示すように、リードフレーム素材の四面からエッチングするため、ラインアンドスペース走査の場合、ライン間隔の加工露印は、板厚の 50~100% 露度とされている。又、リードフレームの板厚露度のアワーリードの露度を考えた場合、一般的には、その露度は約 0.125 mm 以上必要とされている。この為、図 10 に示すようなエッチング加工露度の場合、リードフレームの板厚を 0.15 mm~0.125 mm 露度まで薄くすることにより、ワイヤボンディングのための必要な露度は 70~80% 露度し、0.165 mm ピッチ板厚の露度なインナーリード部先端のエッチングによる加工を達成してきたが、これが露度とされていた。

(0004) しかしながら、近年、封止部半導体装置は、小パッケージでは、電極端子であるインナーリードのピッチが 0.165 mm ピッチを越して、既に 0.15~0.13 mm ピッチまでの狭ピッチ化露度がでてきたりと、エッチング加工において、リードフレームの板厚を薄した場合には、アセンブリ工法や実装工法といった工法におけるアワーリードの露度露度が厳しいという点から、既にリードフレームの板厚を薄くしてエッチング加工を行う方法にし露度が出てきた。

(0005) これに対応する方法として、アワーリードの露度を確保したまま露度化を行う方法で、インナーリード部分をハーフエッチングもしくはプレスにより薄くしてエッチング加工を行う方法が開発されている。しかし、プレスにより薄くしてエッチング加工をおこなう場合には、露工法においての露度が不足する（例えば、のつてエリアの露相）ボンディング、モールディング等のクランプに必要なインナーリードの露度性、露度露度が露度されない、露度を露度しなければならない露度露度が露度になら、露度露度が多くある。そして、インナーリード部分をハーフエッチングにより薄く

してエッティング加工を行う方法の場合にし、部品を2次元化しなければならず、製造工程が複雑になるという問題があり、いずれも実用化には、まだ至っていないのが現状である。

(10006)

(発明が解決しようとする課題) 一方、半導体の発展小化の研究にはい、半導体パッケージにおいても、小型で実用性が高いものが求められるようになってきて、外見寸法をほぼ半導体素子に合わせて、封止用樹脂により樹脂封止したCSP (CHIP SIZE Package) と言われるパッケージが開発されるようになってきた。CSPを使う恩恵を以下に簡単に述べる。

○第一にピン数が同じなら、QFP (Quad Flat Pack Package) やBGA (Ball Grid Array) にはべ実装面積を格段に小さくできる。の第二に、パッケージ寸法が同じならQFPやBGAよりもピン数を多くとれる。QFPについては、パッケージや基板の反りを考慮すると、実用的に使える寸法は最大40mm角であり、アウターリードピッチが0.5mmのピッチのQFPでは304ピンが限界となる。どうにピン数を増やすためには、0.4mmピッチや0.3mmピッチが必要となるが、この場合には、ユーザが基板の高い実装 (一括リフロー・ハンダ付け) を行うのが難しくなってくる。一般にはQFPの実装に際してはアウターリードピッチが0.3mmピッチ以下ではコストを上げずに実装するのは困難と言われている。BGAは、上記QFPの難点を打消すものとしない日を始めたもので、外部端子を二次元アレイ化にし、外部端子ピッチを広げることで実装の実現を検討しようとするものである。BGAの場合、外部端子が300ピンを越える領域でも、従来通りの一括リフロー・ハンダ付けができるが、30mm~40mm角になると、基板サイクルによって外部端子のハンダ・バンプにクラックが入るため、600ピン~700ピン、最大でも1000ピンが実用の限界と一般には言われている。外部端子をパッケージ基板に二次元アレイに抜けたCSPの場合には、BGAのコンセプトを引き継ぎ、且つ、アレイ状の端子ピッチを増やすことが可能となる。また、BGA同様、一括リフロー・ハンダ付けが可能である。

○第三に、QFPやBGAにはべうとパッケージ内部の距離が遠かくなるため、電気的距離が小さくなり伝送遅延時間が遠くなる。LSIクロック周波数が100MHzを越えるようになると、QFPではパッケージ内の距離が問題になってしまふ。内部距離を遠かくしたCSPの方が有利である。しかしながら、CSPは実装面では優れるものの、多様化に対しては、端子のピッチをさらに求めることが必須で、この点での限界がある。本発明は、このような両者のと、リードフレームを用いた既存封止型を基準において、多様化に対応して、且つ、一層の小型化に力をこめる半導体を展開す。

しようとするものである。

(10007)

(発明を成するための手段) 本発明の樹脂封止型半導体部品は、2次エッティング加工によりインナーリードの端をリードフレーム基材の端よりも内側に外側加工されたリードフレームを用い、外見寸法をほぼ半導体素子に合わせて封止用樹脂により樹脂封止したCSP (CHIP SIZE Package) 型の半導体部品であって、前記リードフレームは、リードフレーム基材よりも薄肉のインナーリードと、該インナーリードに一側に差ししたリードフレーム基材と同じ端をの外側面と接続するための形状の端子部とを有し、且つ、端子部はインナーリードの外側面においてインナーリードに対して厚み方向に直交し、かつ半導体素子の反対側と反対側に抜けられ、端子部の先端部に半導体からなる端子部を抜け、端子部を封止用樹脂部から露出させ、端子部の外側面の側面を封止用樹脂部から露出させており、半導体素子は、半導体素子の電極部 (パッド) を有する面にて、インナーリード部に端子部を介して接続されており、半導体素子の電極部 (パッド) はインナーリード間に抜けられ、半導体素子反対側とは反対側のインナーリード先端部とワイヤにて電気的に接続されていることを特徴とするものである。また、本発明の樹脂封止型半導体部品は、2次エッティング加工によりインナーリードの端をリードフレーム基材の端よりも薄肉に外側加工されたリードフレームを用い、外見寸法をほぼ半導体素子に合わせて封止用樹脂により樹脂封止したCSP (CHIP SIZE Package) 型の半導体部品であって、前記リードフレームは、リードフレーム基材よりも薄肉のインナーリードと、該インナーリードに一側に差ししたリードフレーム基材と同じ端をの外側面と接続するための形状の端子部とを有し、且つ、端子部はインナーリードの外側面においてインナーリードに対して厚み方向に直交し、かつ半導体素子の反対側と反対側に抜けられ、端子部の先端部を封止用樹脂部から露出させて端子部とし、端子部の外側面の側面を封止用樹脂部から露出させており、半導体素子は、半導体素子の電極部 (パッド) を有する面にて、インナーリード部に端子部を介して接続されており、半導体素子の電極部 (パッド) はインナーリード間に抜けられ、半導体素子反対側とは反対側のインナーリード先端部とワイヤにて電気的に接続されていることを特徴とするものである。そして上記において、既存型しないしてリードフレームはダイパッドを有しており、半導体素子はその電極部 (パッド) をインナーリード部とダイパッド部との間に接続していることを特徴とするものである。また、本発明の樹脂封止型半導体部品は、2次エッティング加工によりインナーリードの端をリードフレーム基材の端よりも内側に外側加工されたリードフレームを用い、外見寸法をほぼ半導体素子に合わせて

封止用部品により封止されたCSP (Chip Size Package) 型の半導体装置であって、前記リードフレームは、リードフレーム素材よりも薄肉のインナーリードと、該インナーリードに一体的に連結したリードフレーム素材と同じ厚さの外縁回路と接続するためのせばの電子部とを有し、且つ、電子部はインナーリードの外縁側においてインナーリードに対して厚み方向に直交し、かつ半導体電子部は電子部外縁側と反対側に受けられており、電子部の先端面に半田等からなる電子部を抜け、電子部を封止用部品から露出させ、電子部の外縁側の側面を封止用部品から露出させており、半導体電子部は、半導体電子部の一面に受けられたパンプを介してインナーリード部に露出され、半導体電子部とインナーリード部とが電気的に接続していることを特徴とするものである。また、本発明の封止用部品は、2段エッチング加工によりインナーリードの厚さがリードフレーム素材の厚さよりも薄肉に外彫加工されたリードフレームを用い、外彫されたせばをばね等の電子部に合わせて封止用部品により封止されたCSP (Chip Size Package) 型の半導体装置であって、前記リードフレームは、リードフレーム素材よりも薄肉のインナーリードと、該インナーリードに一体的に連結したリードフレーム素材と同じ厚さの外縁回路と接続するためのせばの電子部とを有し、且つ、電子部はインナーリードの外縁側においてインナーリードに対して厚み方向に直交し、かつ半導体電子部は電子部外縁側と反対側に受けられており、電子部の先端の一面を封止用部品から露出させて電子部とし、電子部の外縁側の側面を封止用部品から露出させており、半導体電子部は、半導体電子部の一面に受けられたパンプを介してインナーリード部に露出され、半導体電子部とインナーリード部とが電気的に接続していることを特徴とするものである。そして上記において、インナーリードは、断面形状が四方形で第1面、第2面、第3面、第4面の4面を有しており、かつ第1面はリードフレーム素材と同じ厚さの他の部分の一方の面と同一平面上にあって第2面に向を合っており、第3面、第4面はインナーリードの内側に向かって凹んだ形状に形成されていることにより、インナーリード部の第2面は平坦面を確保でき、ワイヤボンディング性の良いものとしている。また第1面も平坦面で、第3面、第4面はインナーリード部に凹凸であるためインナーリード部は、定位しており、且つ、ワイヤボンディングの平坦面を広くとれる。

(0008)

【作業】本発明の封止用部品半導体装置に、上記のように構成することにより、リードフレームを用いた封止用部品において、多電子部に対応でき、且つ、実用性の良い小型の半導体装置の製造を可能とするものであり、同時に、後段の図11 (b) に示す單層リードフレームを用いた場合のように、ダムバーのプレスによる除去工程や、アウターリードのフォーミング工程を必要としないため、これらの工程に屈屈して見えていたアウターリードのスキューブの問題やアウターリードの半導体 (コープラナリティー) の問題を全く無くすことができる半導体装置の製造を可能とするものである。詳しくは、2段エッチング加工によりインナーリード部の厚さが素材の厚さよりも薄肉に外彫加工された、即ち、インナーリードを側面に加工された多ビンのリードフレームを用いていることにより、半導体装置の多電子化に対応できるものとしており、且つ、外縁サビをばね等の電子部に合わせて、封止用部品により封止されたCSP (Chip Size Package) 型の半導体装置としていることにより、小型化して作製することを可能としている。更に、後述する、図8に示す2段エッチングにより形成された、インナーリードは、断面形状が四方形で第1面、第2面、第3面、第4面の4面を有しており、かつ第1面はリードフレーム素材と同じ厚さの他の部分の一方の面と同一平面上にあって第2面に向を合っており、第3面、第4面はインナーリードの内側に向かって凹んだ形状に形成されていることにより、インナーリード部の第2面は平坦面を確保でき、ワイヤボンディング性の良いものとしている。また第1面も平坦面で、第3面、第4面はインナーリード部に凹凸であるためインナーリード部は、定位しており、且つ、ワイヤボンディングの平坦面を広くとれる。

【0009】また、本発明の封止用部品半導体装置は、半導体電子部が、半導体電子部の一面に受けられたパンプを介してインナーリード部に露出され、半導体電子部とインナーリード部とが電気的に接続していることにより、ワイヤボンディングの必要がなく、一層したボンディングを可能としている。

(0010)

【実施例】本発明の封止用部品半導体装置の実施例を図にそって説明する。先ず、実施例1を図1に示し、説明する。図1 (a) は実施例1の封止用部品半導体装置の断面図であり、図1 (b) (イ) は図1 (a) のA1-A2におけるインナーリード部の断面図で、図1 (b) (ロ) は図1 (a) のB1-B2における電子部の断面図である。図1中、100は半導体装置、110は半導体電子部、111は電極部 (パッド) 、120はワイヤ、130はリードフレーム、131はインナーリード、131Aは第1面、131Bは第2面、131ACは第3面、131ADは第4面、131AEは第5面、131AFは第6面、131AGは第7面、131AHは第8面。

133Aは電子部、133Bは前面、140は封止用端子、150は地盤用端子、160は端子用テープある。本実施例1の断面封止型半導体装置においては、半導体電子110は、半導体電子の電極部（パッド）111側の面で電極部（パッド）111がインナーリード間に収まるようにして、インナーリード131に接着用端子150を介して固定されている。そして、電子部111は、ワイヤ120にて、インナーリード部131の先端の第2面131Aと電気的に接続されている。本実施例1の半導体装置100と外部回路との電気的な接続は、電子部133先端部に抜けられた半導体の半田からなる電子部133Aを介してプリント基板等へ接続されることにより行われる。本実施例1の半導体装置100に使用のリードフレーム130は、42%ニッケル-鉄合金を基材としたもので、そして、図6 (a) に示すような形状をしたエッティングにより外側加工されたリードフレームを用いたものである。電子部133他の部分より専門にお成されたインナーリード131をもつ。ダムバー136は断面封止する際のダムとなる。且、図6 (a) に示すような形状をしたエッティングにより外側加工されたリードフレームを、本実施例においては用いたが、インナーリード部131と電子部133以外は6箇所に不要なものであるから、特にこの形状に固定はされない。インナーリード部131の厚さは4.0mm、インナーリード部131以外の厚さは、12.0、15mmでリードフレーム素材の板厚のままである。また、インナーリードピッチは0.12mmと長いピッチで、半導体装置の多面化に対応できるものとしている。インナーリード部131の第2面131Aは平坦せず、ワイヤボンディングし易い形状となっており、第3面131A C、第4面131A Dはインナーリード側へ凹んだ形状をしており、第2ワイヤボンディング面を良くしても複数的に良いものとしている。且、図6 (b) は図6 (a) のC1-C2における断面を示している。端子用テープ160はインナーリード部にヨレが発生しないように固定しておくものである。且、インナーリードの端子が短かい場合には図6 (a) に示す形状のリードフレームをエッティング加工にして加工し、これに接続する方法により半導体電子を固定して断面封止できるが、インナーリードが長く、インナーリードにヨレを生じ易い場合には端子部160 (a) に示すようにエッティング加工することは出来ないため、図6 (c) (イ) に示すようにインナーリード先端部を端子部131Bにて固定した状態にエッティング加工した後、インナーリード131部を端子用テープ160で固定し（図6 (c) (ロ)）、次いでプレスにて、半導体装置作製の際に不満の端子部131Bを除去し、この状態で半導体電子を固定して半導体装置を作製する。（図6 (c) (ハ)）

図6 (c) (c) 中E1-E2にプレスにて切断する

インを示している。

（0011）次に本実施例1の断面封止型半導体装置の製造方法を図5にとづいて簡単に説明する。先ず、後述するエッティング加工にて作製され、不要の部分をカッティング処理等で除去されたものを、インナーリード先端部端子部が図5で上になるようにして用意した。且、インナーリード131部の長さが長い場合には、必要に応じて、インナーリードの先端部がボリュミドテープによりテープング固定されているものを用意する。次いで半導体電子110の電極部111側面を図5で下にして、インナーリード131側にめり、端子部131を介してインナーリード131に固定固定した。（図5 (a)）

半導体電子110をリードフレーム130に固定固定した後、リードフレーム部130を半導体の上にして、半導体電子110の電極部111とインナーリード部131の先端部とをワイヤ120にてボンディング接続した。（図5 (b)）

次いで、端子の封止用端子140で端子封止を行った。（図5 (c)）

端子による封止は所定の型を用いて行うが、半導体電子110のサイズで、且つ、リードフレームの電子部の外側の面が半導体から外側へ突出した状態で封止した。次いで、不要なリードフレーム130の封止用端子140側から突出している部分をプレスにて切断し、電子部133を固定するとともに電子部133の側面133Bを形成した。（図5 (d)）

この時、切断されるリードフレームのラインには、切断がし易いように、ワイヤスを設けておくと良い。特に、これらのワイヤスはエッティング時に、削せて加工しておけば手間が省ける。図6に示すリードフレーム110のダムバー136、フレーム部137等が削除される。この後、リードフレームの電子部の外側の面に半田からなる電子部133Aを作製して半導体装置を作製した。（図5 (e)）

この半田からなる電子部133Aは外部回路基板と接続する際に、接続し易いように設けてあるが外に設けなくて良い。

（0012）本実施例の半導体装置に用いられるリードフレームの製造方法を以下、図8にそって説明する。図8は、本実施例1の断面封止型半導体装置に用いられたリードフレームの製造方法を説明するための、インナーリード先端部を含む端子における加工面図であり、ここで示されるリードフレームを示す半導体である図6 (a) のD1-D2部の断面部における加工面図である。図8中、810はリードフレーム部材、820A、820Bはレジストバーチ、830は第一の凹部、840に第二の凹部、870は平坦部、880にニッティング端子部、131Aにインナーリード先端部、131A-D12

インナーリードの第2面を示す。たとえば、42×100mmの板合板からなり、厚みが0.15mmのリードフレーム素材810の両面に、電気炉で溶かした水銀性カゼインレジストを塗布した後、所定のパターンを用いて、所定形状の第一の凹部830、第二の凹部840を形成した。(図8(a))

第一の凹部830は、後のエッティング加工においてリードフレーム素材810をこの凹部からベタ状にリードフレーム素材よりも薄肉に露出するためのもので、レジストの第二の凹部840は、インナーリード先端部の形状を形成するためのものである。第一の凹部830は、少なくともリードフレーム810のシナーリード先端部形成領域を含むが、後工程において、テーピングの工程や、リードフレームを固定するクランプ工程で、ベタ状に露出された部分的に薄くなつた部分との接着が原因になる場合があるので、エッティングを行うエリアはインナーリード先端部の露出加工部分だけにせず大きめにとる必要がある。次いで、被膜57°C、比重4.8ボーメの植化第二鉄粉を用いて、スプレー圧2.5kg/cm²にて、レジストパターンが形成されたリードフレーム素材810の両面をエッティングし、ベタ状(平滑状)に露出された第一の凹部830の底をとがリードフレーム素材の約2/3程度に達した時までエッティングを止めた。(図8(b))

上記第1回目のエッティングにおいては、リードフレーム素材810の両面から同時にエッティングを行つたが、必ずしも両面から同時にエッティングする必要はない。少なくとも、インナーリード先端部形状を形成するための所定形状の凹部をもつレジストパターン820Bが形成された面側から單側面によろエッティング加工を行い、露出されたインナーリード先端部形成領域において、所定エッティング加工し止めることがでれば良い。本実験例のように、第1回目のエッティングにおいてリードフレーム素材810の両面から両面にエッティングする場合は、両面からエッティングすることにより、は延する第2回目のエッティング時間を見越すためで、レジストパターン820B側からのみの片面エッティングの場合と比べ、第1回目エッティングと第2回目エッティングのトータル時間が短縮される。次いで、第一の凹部830側の露出された第一の凹部830にエッティング抵抗層880としての耐エッティング性のあるホットメルト型ワックス(ブ・インクテック社製の耐ワックス、型番MR-WB6)を、ダイコータを用いて、塗布し、ベタ状(平滑状)に露出された第一の凹部830に塗り込んだ。レジストパターン820B上にはニッティング抵抗層880に塗布された状態とした。(図8(c))

エッティング抵抗層880を、レジストパターン820B上を單面に塗布する事はないが、第一の凹部830を含む一気にのみ塗布することに留め、図8(c)に示す

ように、第一の凹部830とともに、第一の凹部830の全面にエッティング抵抗層880を塗布した。本実験例で使用したエッティング抵抗層880は、アルカリ性のワックスであるが、基本的にエッティング時に耐性があり、エッティング時にある程度の耐性があるのである。詳しくは、特に、上記ワックスに固定されず、UV硬化型のものでし難い。このようにニッティング抵抗層880をインナーリード先端部の形状を形成するためのパターンが形成された面側の露出された第一の凹部830に塗り込みことにより、後工程でのエッティング時に第一の凹部830が露出されて大きくなつないようにしていふとともに、高機能なエッティング加工に対しての適切な被膜面積をしており、スプレー圧を高く(2.5kg/cm²以上)とすることがで、これによりエッティングが面を方向に進行し易くなる。このは、第2回目エッティングを行い、ベタ状(平滑状)に露出された第一の凹部830を形成面側からリードフレーム素材810をエッティングし、露出させ、インナーリード先端部890を形成した。(図8(d))

第1回目のエッティング加工にて形成された、リードフレーム面に平行なエッティング抵抗層は平滑であるが、この面を抜む2面はインナーリード側にへこんだ凹状である。次いで、既存、エッティング抵抗層880の除去、レジスト層(レジストパターン820A、820B)の除去を行い、インナーリード先端部890が露出加工された図8(d)に示すリードフレームを得た。エッティング抵抗層880とレジスト層(レジストパターン820A、820B)の除去に水酸化ナトリウム水溶液により溶解した。

(0013) 例、上記のように、エッティングを2段階にわけて行うエッティング加工方法を、一般には2段エッティング加工方法といつており、再び、露地加工に適切な加工方法である。本発明に用いた図8(e)、図8(f)に示す、リードフレーム130の露地においては、2段エッティング加工方法と、パターン形状を工夫することにより部分的にリードフレーム素材を薄くしながら外層加工する方法とが併行してはらされている。上記の方法によるインナーリード先端部131Aの露地化加工は、第二の凹部860の底状と、最終的に得られるインナーリード先端部の底面に左右されるもので、例えば、底面を50μmまで薄くすると、図8(e)に示す、平底はW1を100μmとして、インナーリード先端部ピッチDが0.15mmまで露地加工可能となる。底面1を30μm程度まで薄くし、平底W1を70μm程度とすると、インナーリード先端部ピッチDが0.12mmまで露地加工が可能となる。底面1、平底W1のとく万本裏ではインナーリード先端部ピッチDは更に狭いピッチまで露地が可能となる。

(0014) このようにエッティング加工にて、インナーリードの底面がせかい現れる、露地工程でインナーリ

ドのヨレが発生しにくい場合には図6 (a) に示す形状のリードフレームはあるが、インナーリードの長さが実施例1の場合には長い場合はインナーリードにヨレが生し易い為、図6 (c) (イ) に示すように、インナーリード先端部から連結部131Bを除いてインナーリード先端部同士を並げた形状にして形成したものモッディング加工にて得て、この後、半導体部には不必要的連結部131Bをプレス等により切断して図6 (a) に示す形状となる。図7 (a)、図7 (b) に示すダイパッド235を有するリードフレーム230を有する場合には、図7 (c) (イ) に示すように、インナーリード231の先端に連結部231Bを除いてダイパッドと直接つながった形状にエッチングにより外観加工した後、プレス等により切断しても良い。又、図7 (b) は図7 (a) のC11-C21における断面図で、図7 (c) 中E11-E21に切れ目を示している。そして、のつさした後に切断すると、たれめつき方式でインナーリードをのつさする場合には、のつさの直角がなく良い品質のリードフレームが得られる。又、前述のように、図6 (c) に示すものを切断し、図6 (a) に示す形状にする際には、図6 (c) (ロ) に示すように、過大、過強のため減圧用テープ160 (ホリイミドテープ) を使用する。図7 (c) に示すものを切断する場合も同様である。図6 (c) (ロ) の状態で、プレス等により連結部131Bを切断すると、半導体電子は、テープをつけた状態のままで、リードフレームに固定され、そのまま機器封止される。

(0015) 本実施例1の半導体部には用いられたリードフレームのインナーリード先端部131Aの断面形状は、図9 (イ) に示すようになっており、エッチング等-30- 基板131Aの幅W1は反対側の面の幅W2より若干大きくなっている。W1、W2 (約100μm) とし、この部分の基板を方向や筋の幅Wよりし大きくなっている。このようにインナーリード先端部の断面は広くなつた断面形状であるため、図8 (ロ) に示すように、どちらの面を用いても半導体電子 (図示せず) とインナーリード先端部131Aとワイヤ120A、120Bによる接続 (ポンディング) がし易いものとなつてているが、本実施例の場合はエッチング面 (図9 (ロ) (a)) をポンディング面としている。図中131Aはエッチング加工による平坦面、131Aはリードフレーム基面、121A、121Bはのつさ面である。エッチング平坦化面がアラビの無い面であるため、図9 (ロ) の (a) の場合は、外に接続 (ポンディング) 面が形成される。図9 (ハ) は図10に示す反対方向にて切られたリードフレームのインナーリード先端部131Cと半導体電子 (図示せず) との接続 (ポンディング) を示すものであるが、この場合もインナーリード先端部131Cの断面は平らではあるが、この部分の断面方向の端にはにペスとくとれない。また基板とリードフレーム素材は

であるが、基板 (ポンディング) 面は本実施例のニッティング平坦面より劣る。図9 (ニ) にプレスによりインナーリード先端部を直角化した後にエッチング加工によりインナーリード先端部931D、931Eを加工したもの、半導体電子 (図示せず) との接続 (ポンディング) を示したものであるが、この場合はプレス歪曲が図に示すように平らになつてないため、どちらの面を用いて接続 (ポンディング) しても、図9 (ニ) の (a)、(b) に示すように接続 (ポンディング) の面に安定性が悪く品質めに問題となる場合が多い。

(0016) 次に実施例1の接続封止型半導体部の実例を示す。図2 (a) は実施例1の接続封止型半導体部の実施例の断面図であり、図2 (c) は実施例半導体部の外観を示すもので、図2 (c) (ロ) は下 (底) 面から見た図で、図2 (c) (イ) は正面図で、図2 (b) は図2 (a) のA1-A2に対応する位置での電子柱の断面図である。実施例半導体部には、実施例1の半導体欠損とは電子部133Aが異なるので、電子部は電子部133の先端部を連結部140から突出したようにしておき、且つ、先端部の表面には底133Cが抜けられており、側を抜けた状態で表面には半田を塗装した状態にする。そして実施例半導体には、この底133C部を通り半田が行き届くようにしている。実施例の半導体部は100Aは、電子部133A以外は、実施例1の半導体部と同じである。

(0017) 次に、実施例2の接続封止型半導体部を示す。図3 (a) は実施例2の接続封止型半導体部の断面図であり、図3 (b) は図3 (a) のA3-A4におけるインナーリード部の断面図で、図3 (c) (イ) は図3 (a) のB3-B4における電子柱部の断面図である。図3中、200は半導体部、210は半導体電子、211は電極部 (パッド) 、220はワイヤ、230はリードフレーム、231はインナーリード、231Aは第1面、231Bは第2面、231Cは第3面、231Dは第4面、233は電子部、233Aは電子部、233Bは電極部、235はダイパッド、240は封止用樹脂、250は連結用樹脂、250Aは封止用樹脂、260は減圧用テープある。本実施例2の場合も、実施例1と同様に、半導体電子210に、半導体電子の電極部 (パッド) 211側の面で電極部 (パッド) 211がインナーリード間に収まるようにして、インナーリード231に連結用樹脂250を介して連結固定されており、電極部211は、ワイヤ220にて、インナーリード部231の先端の第2面231Aと電気的に接続されているが、リードフレームにダイパッド235を取付うして、半導体電子210の電極部211はインナーリード部231とダイパッド235間に抜けている。また、本実施例2の場合も、実施例1と同様に、半導体部200との接続部との電気的な接続は、電子部233A先端部に抜けられた半導体の半田が

うなる電子部 233A を介してプリント基板等へ伝達されることにより行われる。本実例においては、ダイパッド 235 と半導体電子 210 を接続する接続部 230A を導電性としており、Bf. ダイパッド 235 と電子基板 33 とはインナーリード (吊りリード) にて接続されていることにより、半導体電子にて発生した熱をダイパッドを介して外部回路へ放散させることができ。尚、接続部 230A を導電性の接続部と必ずしもしたくはないが、ダイパッド 235 を電子部 233A を介してグランドラインに接続すると、半導体電子 210 がノイズに強くなるとともに、ノイズを受けない製造となる。

(0018) 実施例 2 の半導体基板に使用のリードフレーム 230 は、実施例 1 にて使用のリードフレームと同様に、42%ニッケル-鉄合金を素材としたものであるが、図 7 (a)、図 7 (b) に示すように、ダイパッド 235 を吊り下ろ形状をしており、電子部 233A はより薄肉に構成されたインナーリード 231 をもつ。インナーリード部 231 の厚さは 40 μm 、電子部 233A は 0.15 mm である。そして、インナーリードピッチは 0.12 mm と長いピッチで、半導体基板の多様化に対応できるものとしている。インナーリード部 231 の第 2 面 231AB は平坦状でワイヤボンディングしやすい形状となっており、第 3 面 231AC、第 4 面 231AD はインナーリード側へ凹んだ形状をしており、第 2 ワイヤボンディング面を強くしても強度的に使いものとしている。また、実施例 2 の断面封止型半導体基板の作製は、実施例 1 の場合とほぼ同じ工程にて行う。

(0019) 実施例 2 の断面封止型半導体基板の実施例としては、図 2 に示す実施例 1 の実施例の場合と同様に、電子部 233 の先端部に第 333C (図 3 (c) (口)) を設け、封止用樹脂 240 から、突出させて、電子部の先端部をそのまま電子部 233A にしたしが避けられる。

(0020) 次いで、実施例 3 の断面封止型半導体基板を舉げる。図 4 (a) は実施例 3 の断面封止型半導体基板の断面図であり、図 3 (b) は図 4 (a) の A5-A6 におけるインナーリード部の断面図で、図 3 (c) (イ) は図 3 (a) の B5-B6 における電子部の断面図である。図 4 中、300 は半導体基板、310 は半導体電子、311 はパンプ、330 はリードフレーム、331 はインナーリード、331A は第 1 面、331A は第 2 面、331AC は第 3 面、331AD は第 4 面、333 は電子部、333A は電子部、333B は側面、335 はダイパッド、340 は封止用樹脂、360 は遮光用テープである。本実施例の半導体基板 300 の場合は、実施例 1 や実施例 2 の場合と異なり、電子部 310 はパンプ 311 を内つしので、パンプ 311 を複数インナーリード 331 に反対固定し、半導体電子 310 とインナーリード 331 とも又逆に吊り下らしの

である。また、本実施例 3 の場合、電子部 310 や電子部 2 の場合と同様に、半導体基板 300 と外側回路との電気的な接続は、電子部 333 が先端部に設けられた電子部の半田からなる電子部 333A を介してプリント基板等へ伝達されることにより行われる。

(0021) 実施例 3 の半導体基板に使用のリードフレーム 330 は、実施例 1 や実施例 2 にて使用のリードフレームと同様に、42%ニッケル-鉄合金を素材としたもので、図 6 (a)、図 6 (b) に示すような形状をもしており、リードフレーム素材と同じ厚さの電子部 333A の部分より薄肉に構成されたインナーリード先端部 331A をもつ。インナーリード先端部 331A の厚さは 40 μm 、インナーリード先端部 331A 以外の厚さは 0.15 mm で、強度的には工性に充分耐えうるものとなっている。そして、インナーリードピッチは 0.12 mm と長いピッチで、半導体基板の多様化に対応できるものとしている。インナーリード先端部 331A の第 2 面 331AB は平坦状でワイヤボンディングしやすい形状となっており、第 3 面 331AC、第 4 面 331AD はインナーリード側へ凹んだ形状をしており、第 2 ワイヤボンディング面を強くしても強度的に使いものとしている。また、実施例 3 の断面封止型半導体基板の作製も、実施例 1 の場合とはほぼ同じ工程にて行うが、ダイパッド 335 に半導体電子を固定し固定した後、封止用樹脂にて断面封止する。

(0022) 実施例 3 の断面封止型半導体基板の実施例としては、図 2 に示す実施例 1 の実施例の場合と同様に、電子部 333 の先端部に第 333C (図 4 (c) (口)) を設け、封止用樹脂 340 から、突出させて、電子部の先端部をそのまま電子部 333A にしたしが避けられる。

(0023) (発明の効果) 本発明の断面封止型半導体基板は、上記のように、リードフレームを用いた断面封止型半導体基板において、多様化に対応して、且つ、導電性良い半導体基板の形状を可能としている。本発明の断面封止型半導体基板に、これと同時に、又の図 11 (b) に示すアウターリード用リードフレームを用いた場合のようにダムバーのカット工程や、ダムバーの曲げ工程を必要としないため、アウターリードのスキューリングや、平面性 (コーブラナリティ) の問題を解消としている。また、QFP や BGA に比べるとパッケージ内部の配線量が豊かとなるため、寄生容量が小さくなり伝送延滞時間を短くすることを可能にしている。

(図面の附記な説明)

- (図 1) 実施例 1 の断面封止型半導体基板の断面図
- (図 2) 実施例 1 の断面封止型半導体基板の断面図
- (図 3) 実施例 2 の断面封止型半導体基板の断面図
- (図 4) 実施例 3 の断面封止型半導体基板の断面図
- (図 5) 実施例 1 の断面封止型半導体基板の作製工程

説明するための図

(図6) 本発明の留置封止型半導体装置に用いられるリードフレームの図

(図7) 本発明の留置封止型半導体装置に用いられるリードフレームの図

(図8) 本発明の留置封止型半導体装置に用いられるリードフレームの作製方法を説明するための図

(図9) インナーリード先端部でのワイヤボンディングの結果状態を示す図

(図10) 従来のリードフレームのエッティング製造工程を説明するための図

(図11) 留置封止型半導体装置及び留置リードフレームの図

(符号の説明)

100. 100A. 200. 300

留置封止型半導体装置

110. 210. 310

導体箔

111. 211. 311

極(バッド)

120. 220. 320

イヤ

120A. 120B

イヤ

121A. 121B

つま黒

130. 230. 330

リードフレーム

131. 231. 331

シナーリード

131Aa. 231Aa. 331Aa

1筋

131Ab. 231Ab. 331Ab

2筋

131Ac. 231Ac. 331Ac

3筋

131Ad. 231Ad. 331Ad

4筋

131B. 231B

起點

133. 233. 333

子位

133A

子M

133B

筋

133C

136. 236

ムバード

137. 237

レーム(10) 及

140. 240. 340

止用板

150

導体箔

160. 260. 360

接着テープ

235

イバッド

10 810

リードフレーム素材

820A. 820B

ジストバーン

830

一の鍛口部

840

二の鍛口部

850

一の凹部

860

二の凹部

870

導体面

880

フチング底次層

920C. 920D. 920E

リ

11

921C. 921D. 921E

イ

つま黒

10 931D. 931E

リードフレーム元端部

931Aa

リードフレーム素材

931Ac

イニシグ面

1010

リードフレーム素材

1020

オトレジスト

10 1030

リ

ジストバーン

1040

シナーリード

1110

リードフレーム

1111

イバッド

1112

シナーリード

11 112A

リ

地

ダ

リ

レ

ス

ス

平

エ

ウ

ウ

ウ

イ

リ

コ

リ

フ

レ

イ

リ

ダ

イ

イ

(11)

特開平9-8207

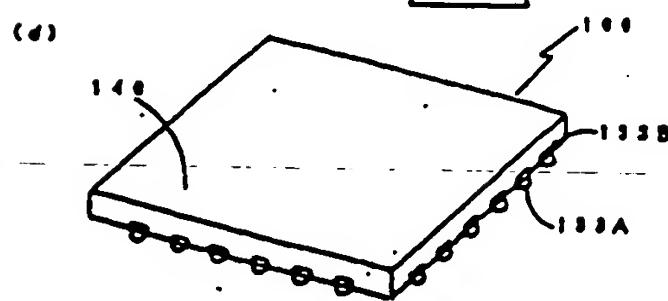
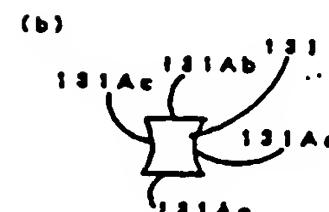
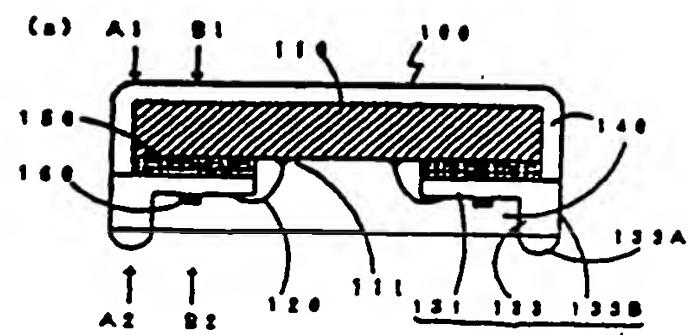
30

シナーリード先端部
1113
クターリード
1114
ムバー
1115
レーム部(押出)
1120

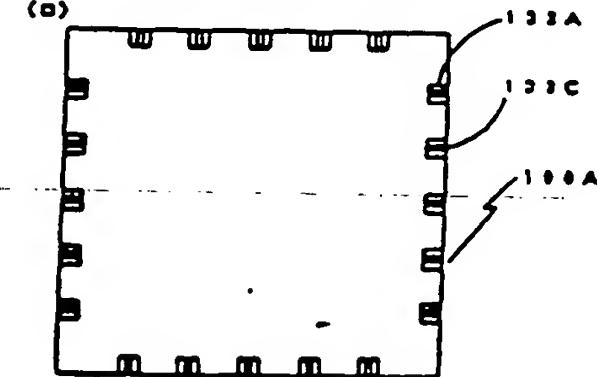
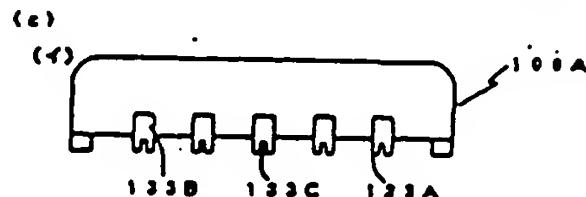
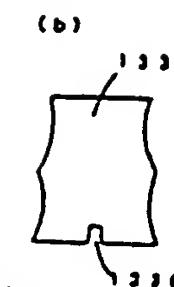
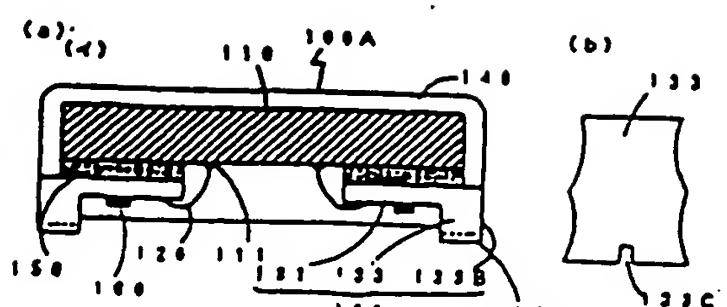
成形部子
1121
医部(パッド)
1130
イヤ
1140
止用脚

19

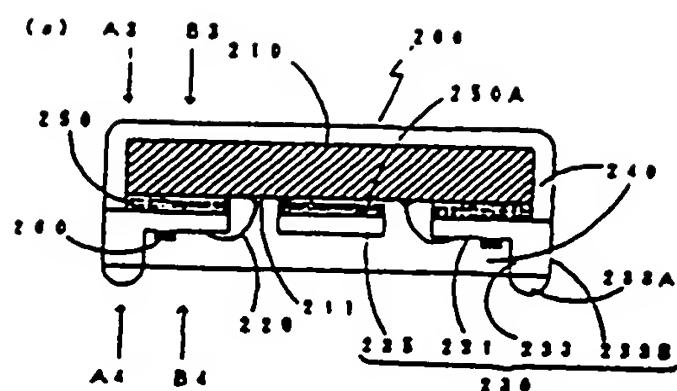
(図1)



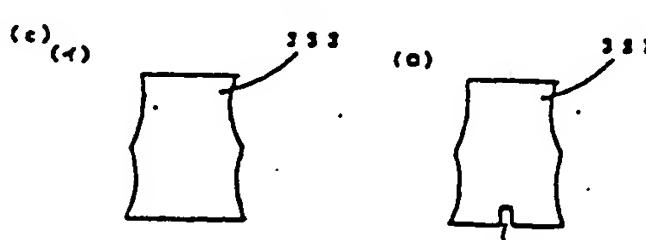
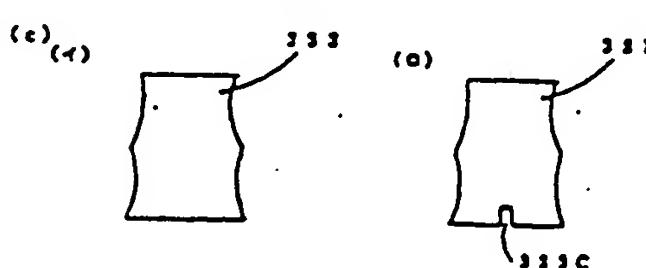
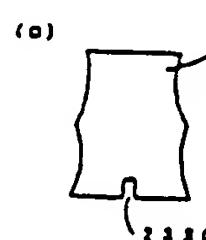
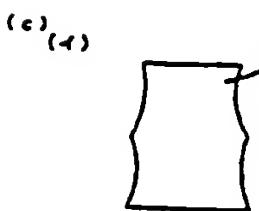
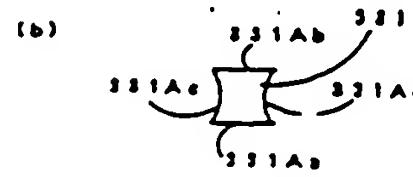
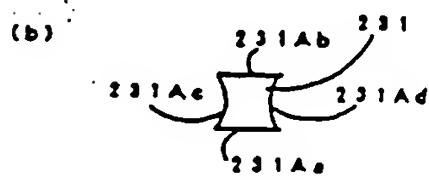
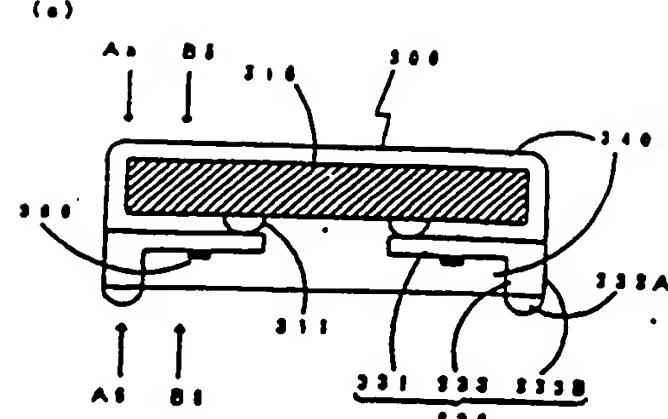
(図2)



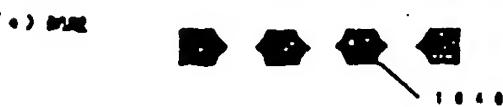
(図 3)



(図 4)



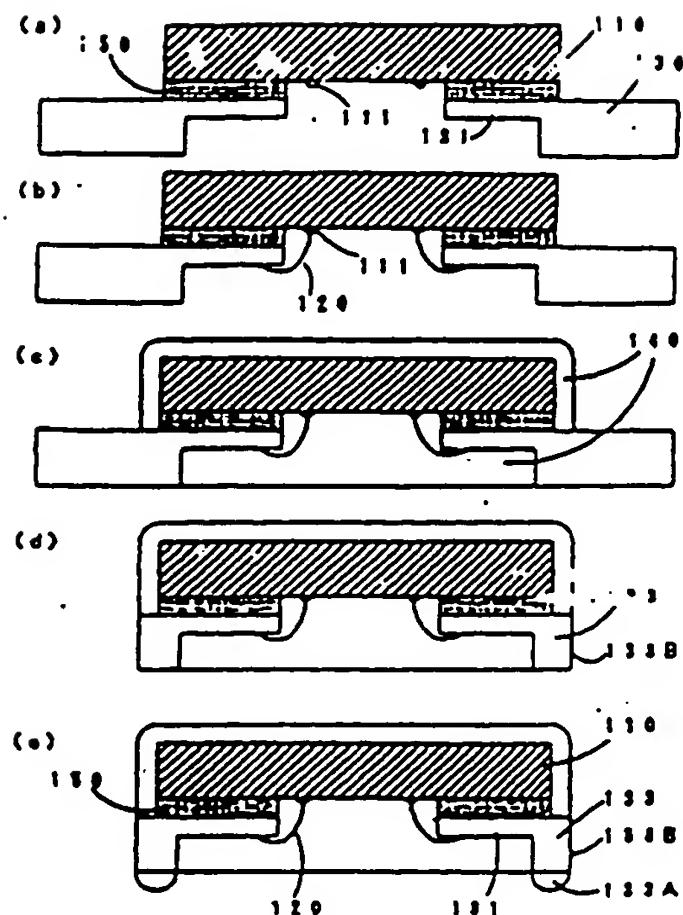
(図 10)



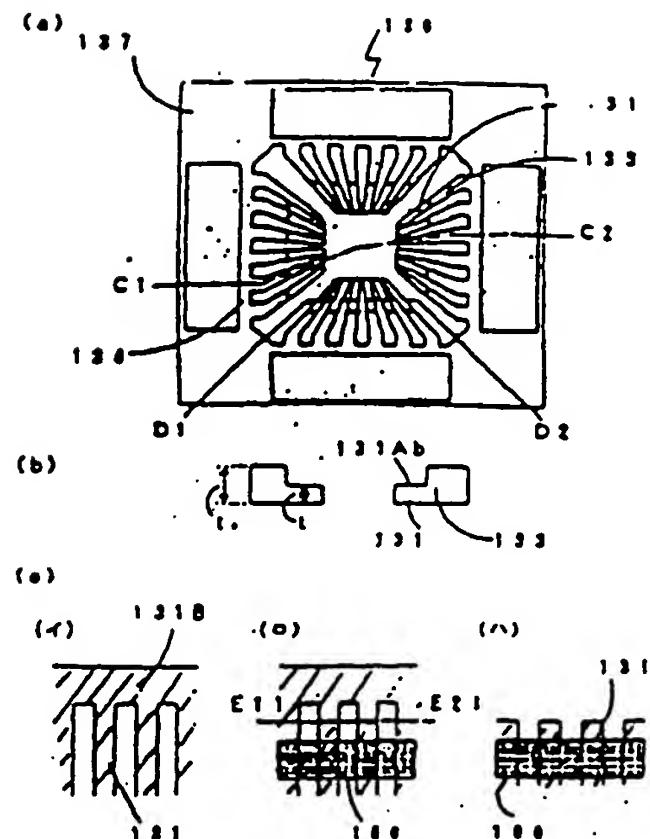
(13)

44-9-6207

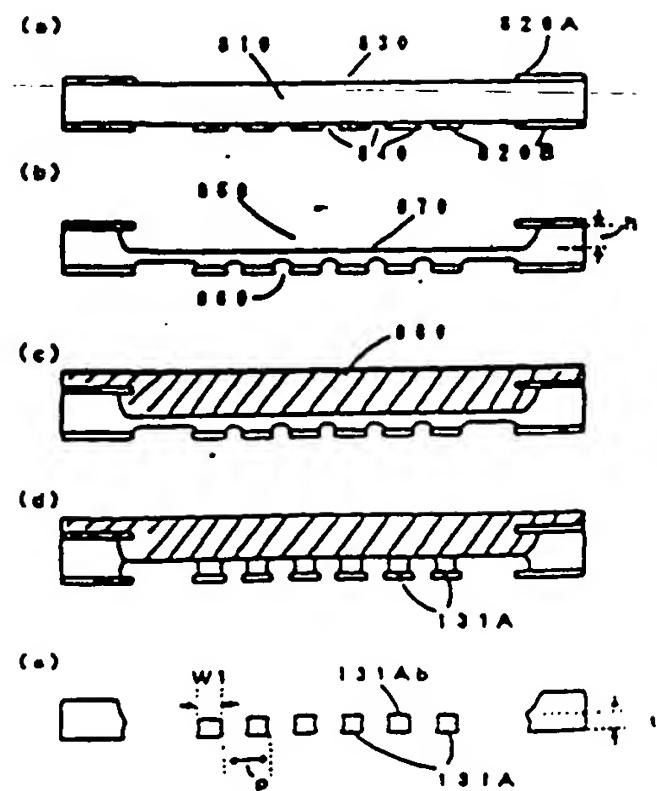
(图5)

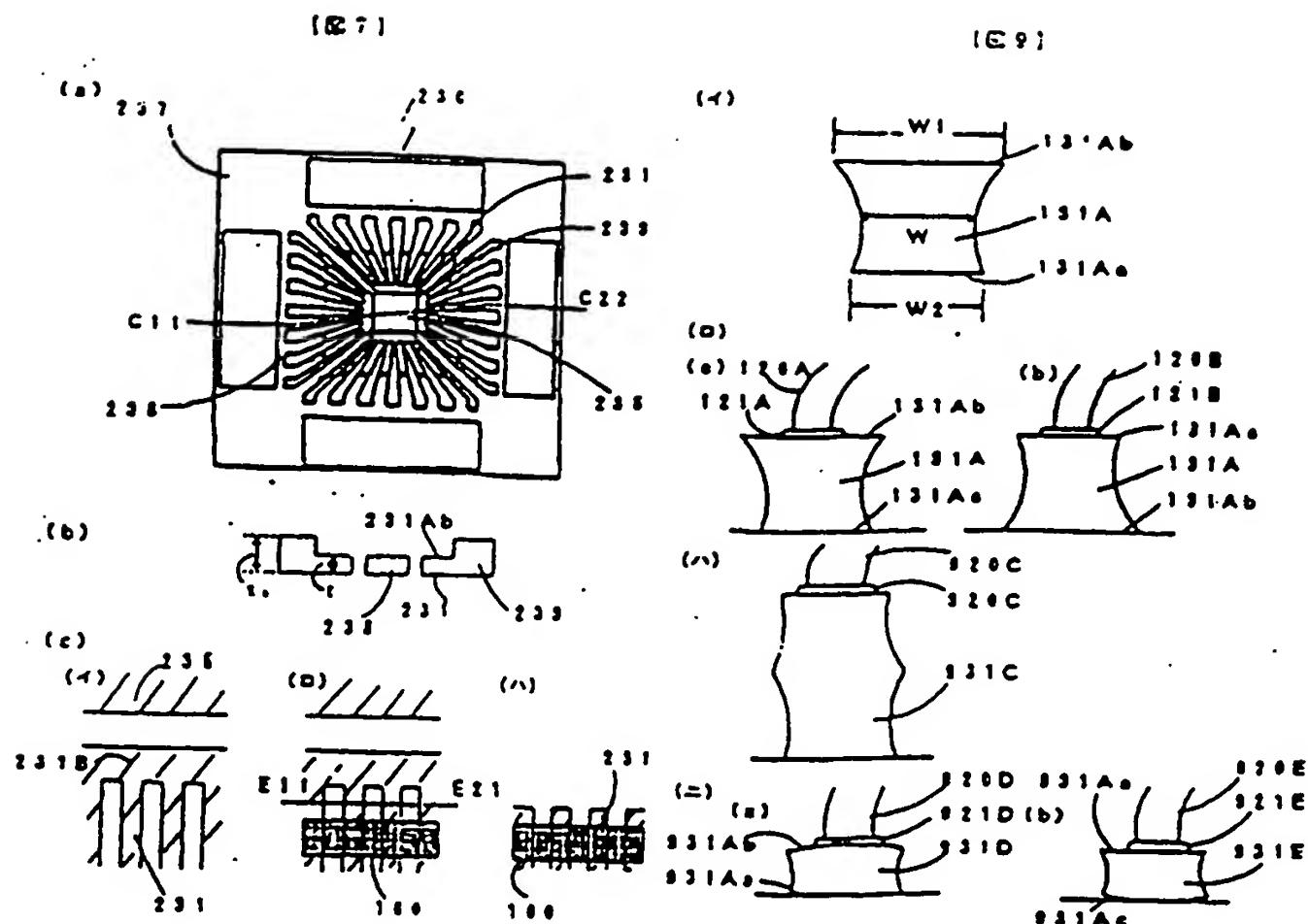


(图6)

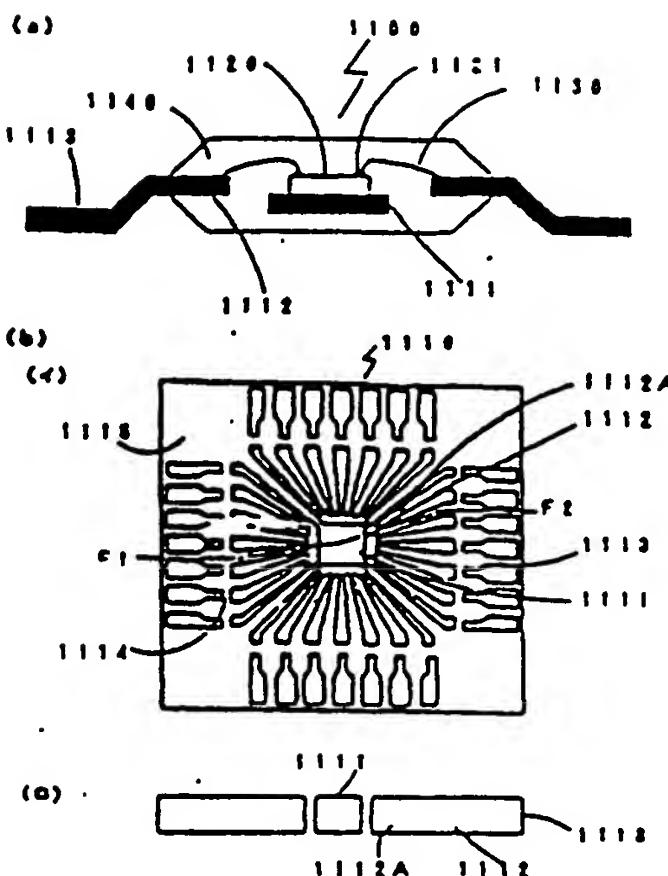


(图8)





(図11)



Japanese Patent Laid-Open Publication No. Heisei 9-8207

[TITLE OF THE INVENTION]

RESIN-ENCAPSULATED SEMICONDUCTOR DEVICE

5

[CLAIMS]

1. A resin-encapsulated CSP type semiconductor device in which a lead frame shaped in accordance with a two-step etching process in such a manner that a thickness of inner leads is thinner than that of the lead frame and which is encapsulated with an encapsulating resin in such a manner that it is substantially the same as that of a semiconductor chip in size, the lead frame including:
 - inner leads having a thickness smaller than that of a lead frame blank;
 - terminal columns having the same thickness as that of the lead frame blank and being integrally connected to the inner leads and also being adapted to be electrically connected to an external circuit;
 - the terminal columns being disposed outside of the inner leads in such a manner that they are coupled to the inner leads in a direction orthogonal to a thickness-wise direction thereof, the terminal columns being mounted on the surface opposite the surface of the lead frame on which the semiconductor chip is mounted, the terminal columns

having terminal portions arranged on their tips;
the terminal portions being made of solder, etc. and
exposed externally through the encapsulating resin such
that the terminal columns are exposed externally through
5 the encapsulating resin at their outer sides; and
the semiconductor chip at its surface having electrode
portions being mounted on the inner leads by means of an
insulating adhesive, and the electrode portions being
arranged between the inner leads and being electrically
10 connected to tips of the inner leads by wires.

2. A resin-encapsulated CSP type semiconductor
device in which a lead frame shaped in accordance with a
two-step etching process in such a manner that a thickness
15 of inner leads is thinner than that of the lead frame and
which is encapsulated with an encapsulating resin in such a
manner that it is substantially the same as that of a
semiconductor chip in size, the lead frame including:
inner leads having a thickness smaller than that of a
20 lead frame blank;
terminal columns having the same thickness as that of
the lead frame blank and being integrally connected to the
inner leads and also being adapted to be electrically
connected to an external circuit;
25 the terminal columns being disposed outside of the

inner leads in such a manner that they are coupled to the inner leads in a direction orthogonal to a thickness-wise direction thereof, the terminal columns being mounted on the surface opposite the lead frame surface on which the

5 semiconductor chip is mounted, the terminal columns being exposed externally through the encapsulating resin at a portion of the tips thereof to serve as terminal portions, the terminal columns being exposed externally through the encapsulating resin at the outer sides thereof; and

10 the semiconductor chip at its surface having electrode portions being mounted on the inner leads by means of an insulating adhesive, and the electrode portions being electrically connected to tips of the inner leads by wires.

15 3. The resin-encapsulated CSP type semiconductor devices of claim 1 or 2, wherein the lead frame has a die pad, and the semiconductor chip is mounted in such a manner that electrode portions thereof are arranged between the 20 inner leads and the die pad.

4. A resin-encapsulated CSP type semiconductor device in which a lead frame shaped in accordance with a two-step etching process in such a manner that a thickness of inner leads is thinner than that of the lead frame and which is 25 encapsulated with an encapsulating resin in such a manner

that it is substantially the same as that of a semiconductor chip in size, the lead frame including:

inner leads having a thickness smaller than that of a lead frame blank;

5 terminal columns having the same thickness as that of the lead frame blank and being integrally connected to the inner leads and also being adapted to be electrically connected to an external circuit;

10 the terminal columns being disposed outside of the inner leads in such a manner that they are coupled to the inner leads in a direction orthogonal to a thickness-wise direction thereof, the terminal columns being mounted on the surface opposite the surface of the lead frame on which the semiconductor device is mounted, the terminal columns 15 having terminal portions arranged on their tips;

the terminal portions being made of solder, etc. and exposed externally through the encapsulating resin such that the terminal columns are exposed externally through the encapsulating resin at the outer sides thereof; and

20 the semiconductor chip being mounted on the inner leads by bumps arranged on one surface of the semiconductor chip, and the semiconductor chip being electrically connected to the inner leads.

25 5. A resin-encapsulated CSP type semiconductor

device in which a lead frame shaped in accordance with a two-step etching process in such a manner that a thickness of inner leads is thinner than that of the lead frame and which is encapsulated with an encapsulating resin in such a 5 manner that it is substantially the same as that of a semiconductor chip in size, the lead frame including:

inner leads having a thickness smaller than that of a lead frame blank;

10 terminal columns having the same thickness as that of the lead frame blank and being integrally connected to the inner leads and also being adapted to be electrically connected to an external circuit;

15 the terminal columns being disposed outside of the inner leads in such a manner that they are coupled to the inner leads in a direction orthogonal to a thickness-wise direction thereof, the terminal columns being mounted on the surface opposite the surface of the lead frame on which the semiconductor device is mounted, the terminal columns being exposed externally through the encapsulating resin at 20 a portion of tips thereof to serve as terminal portions; and

25 the semiconductor chip being mounted on the inner leads by bumps arranged on one surface thereof, and the semiconductor chip being electrically connected to the inner leads.

6. The resin-encapsulated CSP type semiconductor device of any of claims 1 to 5, wherein the inner leads each have a rectangular cross-sectional shape including 5 four faces respectively provided with a first surface, a second surface, a third surface, and a fourth surface, the first surface being opposite to the second surface and flush with one surface of the remaining portion of the inner lead having the same thickness as that of the lead 10 frame blank, and the third and fourth surfaces each having a concave shape depressed toward the inside of the inner lead.

[DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION]

15 [FIELD OF THE INVENTION]

The present invention relates to a resin-encapsulated semiconductor device capable of meeting the requirement for an increase in the number of terminals and having a 20 miniaturized structure and thus an excellent mounting efficiency. More particularly, the present invention relates to a resin-encapsulated semiconductor device utilizing a lead frame shaped in a manner that an inner lead portion is thinner in a thickness than a lead frame blank.

[DESCRIPTION OF THE PRIOR ART]

Fig. 11a shows the configuration of a generally known resin-encapsulated semiconductor device (a plastic lead frame package). The shown resin-encapsulated semiconductor device includes a die pad 1111 having a semiconductor chip 1120 mounted thereon, outer leads to be electrically connected to the associated circuits, inner leads 1112 formed integrally with the outer leads 1113, bonding wires 1130 for electrically connecting the tips of the inner leads 1112 to the bonding pad 1121 of the semiconductor chip 1120, and a resin encapsulating the semiconductor chip 1120 to protect the semiconductor chip 1120 from external stresses and contaminants. This resin-encapsulated semiconductor device, after mounting the semiconductor device 1120 on the bonding pad 1121, is manufactured by encapsulating the semiconductor chip 1120 with the resin. In this resin-encapsulated semiconductor device, the number of the inner leads 1112 is equal to that of the bonding pads 1121 of the semiconductor chip 1120. And, Fig. 11b shows the configuration of a monolayer lead frame used as an assembly member of the resin-encapsulated semiconductor device shown in Fig. 11a. Such a lead frame includes the bonding pad 1111 for mounting the semiconductor chip, the inner leads 1112 to be electrically connected to the semiconductor device, the outer lead 1113 which is integral

with the inner lead 1112 and is adapted to be electrically connected to the associated circuits. This also includes dam bars serving as a dam when encapsulating the semiconductor device with the resin, and a frame serving to support the entire lead frame 1110. Such a lead frame is formed from a highly conductive metal such as a cobalt, 42 alloy(a 42% Ni-Fe alloy), copper-based alloy by a pressing working process or an etching process.

Recently, there has been growing demand for the miniaturization and reduction in thickness of resin-encapsulated semiconductor device employing lead frames like the lead frame 1110(plastic lead frame package) and the increase of the number of terminals of resin-encapsulated semiconductor package as electronic apparatuses are miniaturized progressively and the degree of the integration of semiconductor device increase progressively. Thus, recent resin-encapsulated semiconductor package, particularly quad-plate package(QFPs) and thin quad flat packages (TQFPs) have each a greatly increased number of pins.

Lead frames having inner leads arranged at small pitches among lead frames for semiconductor packages are fabricated by a photolithographic etching process, while lead frames having inner leads arranged at comparatively large pitches among lead frames for semiconductor packages

are fabricated by press working. However, lead frames having a large number of fine inner leads to be used for forming semiconductor packages having a large number of pins are fabricated by subjecting a blank of a thickness on the order of 0.25 mm to an etching process, not a press working.

5 The etching process for forming a lead frame having fine inner leads will be described hereinafter with reference to Fig. 10. First a copper alloy or 42 alloy thin sheet 1010 of a thickness on the order of 0.25 mm (blank for a lead frame) is cleaned perfectly (Fig. 10a). Then, a 10 photoresist, such as a water-soluble casein photoresist containing potassium dichromate as a sensitive agent, is spread in photoresist films 1020 over the major surfaces of 15 the thin film as shown in Fig. 10b. Then, the photoresist films are exposed, through a mask of a predetermined pattern, to light emitted by a high-pressure mercury lamp, and the thin sheet is immersed in a developer for development to form a patterned photoresist film 1030 as 20 shown in Fig. 10c. Then, the thin sheet is subjected, when need be, to a hardening process, a washing process and such, and then an etchant containing ferric chloride as a 25 principal component is sprayed against the thin sheet 1010 to etch through portions of the thin sheet 1010 not coated with the patterned photoresist films 1020 so that inner

leads of predetermined sizes and shapes are formed as shown in Fig. 10d.

Then, the patterned resist films are removed, the patterned thin sheet 1010 is washed to complete a lead frame having the inner leads of desired shapes as shown in Fig. 13e. Predetermined areas of the lead frame thus formed by the etching process are silver-plated. After being washed and dried, an adhesive polyimide tape is stuck to the inner leads for fixation, predetermined tab bars are bent, when need be, and the die pad depressed. In the etching process, the etchant etches the thin sheet in both the direction of the thickness and directions perpendicular to the thickness, which limits the miniaturization of inner lead pitches of lead frames. Since the thin sheet is etched from both the major surfaces as shown in Fig. 10 during the etching process, it is said, when the lead frame has a line-and-space shape, that the smallest possible intervals between the lines are in the range of 50 to 100% of the thickness of the thin sheet. From the viewpoint of forming the outer lead having a sufficient strength, generally, the thickness of the thin sheet must be about 0.125 mm or above. Furthermore, the width of the inner leads must be in the range of 70 to 80 μ m for successful wire bonding. When the etching process as illustrated in Fig. 10 is employed in fabricating a lead frame, a thin sheet of a small

thickness in the range of 0.125 to 0.15 mm is used and inner leads are formed by etching so that the fine tips thereof are arranged at a pitch of about 0.165 mm.

However, recent miniature resin-encapsulated 5 semiconductor package requires inner leads arranged at pitches in the range of 0.013 to 0.15 mm, far smaller than 0.165 mm. When a lead frame is fabricated by processing a thin sheet of a reduced thickness, the strength of the outer leads of such a lead frame is not large enough to 10 withstand external forces that may be applied thereto in the subsequent processes including an assembling process and a chip mounting process. Accordingly, there is a limit to the reduction of the thickness of the thin sheet to enable the fabrication of a minute lead frame having fine 15 leads arranged at very small pitches by etching.

An etching method previously proposed to overcome such difficulties subjects a thin sheet to an etching process to form a lead frame after reducing the thickness of portions of the thin sheet corresponding to the inner leads of the lead frame by half etching or pressing to form the fine inner leads by etching without reducing the strength of the outer leads. However, problems arise in accuracy in the 20 subsequent processes when the lead frame is formed by etching after reducing the thickness of the portions corresponding to the inner leads by pressing; for example, 25

the smoothness of the surface of the plated areas is unsatisfactory, the inner leads cannot be formed in a flatness and a dimensional accuracy required to clamp the lead frame accurately for bonding and molding, and a platemaking process must be repeated twice making the lead fabricating process intricate. It is also necessary to repeat a platemaking process twice when the thickness of the portions of the thin sheet corresponding to the inner leads is reduced by half etching before subjecting the thin sheet to an etching process for forming the lead frame, which also makes the lead frame fabricating process intricate. Thus, this previously proposed etching method has not yet been applied to practical lead frame fabricating processes.

15

[SUBJECT MATTERS TO BE SOLVED BY THE INVENTION]

Meanwhile, there has been growing demand for the miniaturization and increase in the mounting efficiency of the semiconductor package as electronic apparatuses are miniaturized progressively. Thus, a package, so called "CSP" (Chip Size Package) is proposed which is encapsulated with a resin in such a manner that its size is substantially equal to that of the semiconductor chip. The CSP has the following advantages.

25

1) First, where the number of pins of the CSP is equal

to that of QFP (Quad Flat Package) or BGA (Ball Grid Package), the CSP enables a remarkable reduction in the mounting area as compared to the QFP or BGA.

2) Second, if the CSP is equal to the QFP or BGA in size, the CSP is increased in the pin number over the QFP or BGA. In the case of the QFP, a practical use dimension is 40 mm or less when considering the length of the package or substrate, and the pin number is 304 or less if the outer leads are arranged at a pitch of 0.5 mm. The outer leads need to be arranged at a pitch of 0.4mm or 0.3 mm to increase the pin number, but this causes a user difficulty in mounting the semiconductor package at a high productivity. Generally, in fabricating the QFP in which the outer leads are arranged at a pitch of 0.3 mm or less, the mass production of the QFP necessarily involves an increase in costs, otherwise the mass production is difficult. The BGA was proposed to overcome such a difficulty of the QFP. In the BGA, external terminals are formed in the shape of two-dimensional array, and arranged at a wider pitch, thereby reducing a difficulty in mounting it. Moreover, although the BGA permits the conventional overall reflow soldering even at the pin number in excess of 300 pins, solder bumps are incorporated with clacks depending on the temperature cycle if the dimension of the BGA reaches 30 to 40 mm, such that an upper limitation of

the pin number of the BGA is 600 to 700 pins, or at most 1000 pins. In the case of the CSP in which external terminals are mounted in the shape of two-dimensional array on the back surface of the CSP, pitches of the external terminals can be increased in accordance with the concepts of the BGA. Moreover, in the CSP, the overall reflow soldering can be permitted, as in the BGA.

3) Third, as compared to the QFP or BGA, the CSP is short in an interconnection length, and thus less in the parasitic capacitance, and thereby short in the transfer delay time. Where the clock rate is in excess of 100 MHZ, the QFP is problematic in transfer into the package. The CSP having a shortened interconnection length is advantageous. Accordingly, the CSP is advantageous in view of the mounting efficiency, but it needs to be narrower in the terminal pitch when considering a demand for an increase in the number of terminals.

Thus, the present invention is aimed to provide a resin-encapsulated semiconductor device employing a lead frame, which is capable of meeting a demand for the miniaturization and increased terminal number.

(MEANS FOR SOLVING THE SUBJECT MATTERS)

25 A resin-encapsulated semiconductor device in
accordance with the present invention is a resin-

encapsulated CSP type semiconductor device in which a lead frame shaped in accordance with a two-step etching process in a manner that a thickness of inner leads is thinner than that of the lead frame and which is encapsulated with an encapsulating resin in such a manner that it is substantially the same as that of a semiconductor chip in size, the lead frame including: inner leads having a thickness smaller than that of a lead frame blank; and terminal columns having the same thickness as that of the lead frame blank and being integrally connected to the inner leads and also being adapted to be electrically connected to an external circuit; the terminal columns being disposed outside of the inner leads in such a manner that they are coupled to the inner leads in a direction orthogonal to thickness-wise direction thereof, the terminal columns being mounted on the surface opposite the surface on which the semiconductor chip is mounted, the terminal columns having terminal portions arranged on their tips; the terminal portions being made of solder, etc. and exposed externally through the encapsulating resin such that the terminal columns are exposed externally through the encapsulating resin at their outer sides; the semiconductor chip at its surface having electrode portions (pads) being mounted on the inner leads by means of an insulating adhesive, and the electrode portions being

electrically connected to tips of the inner leads by wires. Moreover, a resin-encapsulated semiconductor device in accordance with the present invention is a resin-encapsulated CSP type semiconductor device in which a lead frame shaped in accordance with a two-step etching process in a manner that a thickness of inner leads is thinner than that of the lead frame and which is encapsulated with an encapsulating resin in such a manner that it is substantially the same as that of a semiconductor chip in size, the lead frame including: inner leads having a thickness smaller than that of a lead frame blank; and terminal columns having the same thickness as that of the lead frame blank and being integrally connected to the inner leads and also being adapted to be electrically connected to an external circuit; the terminal columns being disposed outside of the inner leads in such a manner that they are coupled to the inner leads in a direction orthogonal to thickness-wise direction thereof, the terminal columns being mounted on the surface opposite the lead frame surface on which the semiconductor chip is mounted, the terminal columns being exposed externally through the encapsulating resin at their outer sides; the semiconductor chip at its surface having electrode portions (pads) being mounted on the inner leads by means of an insulating adhesive, and the electrode portions being

arranged between the inner leads and electrically connected to tips of the inner leads by wires.

In the resin-encapsulated CSP type semiconductor devices as described above, the lead frame has a die pad, 5 and the semiconductor chip is mounted in such a manner that their electrode portions is arranged between the inner leads and the die pad.

Furthermore, a resin-encapsulated semiconductor device in accordance with the present invention is a resin- 10 encapsulated CSP type semiconductor device in which a lead frame shaped in accordance with a two-step etching process in a manner that a thickness of inner leads is thinner than that of the lead frame and which is encapsulated with an encapsulating resin in such a manner that it is 15 substantially the same as that of a semiconductor chip in size, the lead frame including: inner leads having a thickness smaller than that of a lead frame blank; and terminal columns having the same thickness as that of the lead frame blank and being integrally connected to the inner leads and also being adapted to be electrically 20 connected to an external circuit; the terminal columns being disposed outside of the inner leads in such a manner that they are coupled to the inner leads in a direction orthogonal to thickness-wise direction thereof, the 25 terminal columns being mounted on the surface opposite the

surface of the lead frame on which the semiconductor device is mounted, the terminal columns having terminal portions arranged on their tips; the terminal portions being made of solder, etc. and exposed externally through the encapsulating resin such that the terminal columns are exposed externally through the encapsulating resin at their outer sides; the semiconductor chip being mounted on the inner leads by bumps arranged on one surface of the semiconductor chip, and the semiconductor chip being electrically connected to the inner leads.

Also, a resin-encapsulated semiconductor device in accordance with the present invention is a resin-encapsulated CSP type semiconductor device in which a lead frame shaped in accordance with a two-step etching process in a manner that a thickness of inner leads is thinner than that of the lead frame and which is encapsulated with an encapsulating resin in such a manner that it is substantially the same as that of a semiconductor chip in size, the lead frame including: inner leads having a thickness smaller than that of a lead frame blank; and terminal columns having the same thickness as that of the lead frame blank and being integrally connected to the inner leads and also being adapted to be electrically connected to an external circuit; the terminal columns being disposed outside of the inner leads in such a manner

that they are coupled to the inner leads in a direction orthogonal to thickness-wise direction thereof, the terminal columns being mounted on the surface opposite the surface of the lead frame on which the semiconductor device is mounted, the terminal columns having terminal portions arranged on their tips; the terminal portions being exposed externally through the encapsulating resin at a portion of tips thereof; the semiconductor chip being mounted on the inner leads by bumps arranged on one surface thereof, and the semiconductor chip being electrically connected to the inner leads.

In the resin-encapsulated CSP type package, the inner leads each have a rectangular cross-sectional shape including four faces respectively provided with a first surface, a second surface, a third surface, and a fourth surface, the first surface being opposite to the second surface and flush with one surface of the remaining portion of the inner lead having the same thickness as that of the lead frame blank, and the third and fourth surfaces each having a concave shape depressed toward the inside of the inner lead.

Meanwhile, the CSP type semiconductor devices as used herein generally means resin-encapsulated semiconductor devices encapsulated with an encapsulating resin in a manner that each of the resulting structures is

lead, the inner leads are stable and wider in their width.

Furthermore, in the resin-encapsulated semiconductor device in accordance with the present invention, a semiconductor chip is mounted on the inner leads by bumps arranged on one surface of the semiconductor chip, and the semiconductor chip and the inner leads are electrically connected to each other. Thus, wire bondings are not required, and also bondings can be carried out in a lump.

10 [EMBODIMENTS]

Embodiments of the resin-encapsulated semiconductor device in accordance with the present invention will now be described with reference to Figures. 1. First, a first embodiment is shown in Fig. 1. Fig 1a is a cross-sectional view of the resin-encapsulated semiconductor device according to the first embodiment of the present invention. Fig. 1b is a cross-sectional view of each of the inner leads taken along the line A1-A2 of Fig. 1a, and Fig 1c is a cross-sectional of each of terminal columns view taken along the line B1-B2 of Fig. 1a. In Fig. 1, a reference numeral 100 depicts a resin-encapsulated semiconductor device, 110 a semiconductor chip, 111 electrode portions (pads), 120 wires, 130 a lead frame, 131 inner leads, 131Aa a first surface, 131Ab a second surface, 131Ac a third surface, 131Ad a fourth surface, 133 terminal columns, 133A

terminal portions, 133B sides, 140 an encapsulating resin, 150 an insulating adhesive, and 160 a reinforcing tape.

In the resin-encapsulated semiconductor device according to the first embodiment, a semiconductor device 110 is mounted in a manner that the electrode portions 111 of the semiconductor chip 110 are arranged between the inner leads. The semiconductor chip 110 is electrically connected to the second surface 131 Ab of the tip of each inner lead 131. The electrical connection of the resin-encapsulated semiconductor device 100 to an external circuit is achieved by mounting the resin-encapsulated semiconductor device 100 at terminal portions made of semi-spherical solder on a printed circuit substrate. The lead frame 130 used in the semiconductor device 100 according to the first embodiment is made of a 42% nickel-iron alloy. This lead frame 130 has a shape as shown in Fig. 6a. As shown in Fig. 6a, the lead frame 130 has inner leads 131 shaped to have a thickness smaller than that of the terminal column 133. Dam bars 136 serve as a dam when encapsulating with a resin. Moreover, although the lead frame processed by etching to have a shape as shown in Fig. 6a is used in this embodiment, the lead frame is not limited to such a shape as portions other than the inner leads and the terminal columns 133 are not required to be used. The inner leads 131 have a thickness of 40 μ m whereas

the portions of the lead frame other than the inner leads 131 have a thickness of 0.15 mm corresponding to the thickness of the lead frame blank. The tips of the inner leads have a fine pitch of 0.12 mm so as to achieve an 5 increase in the number of terminals for semiconductor devices. The second face denoted by the reference numeral 131Ab is a surface etched, but having a substantially flat profile, so as to allow an easy wire bonding thereon. The 10 third and fourth faces 131Ac and 131Ad have a concave shape depressed toward the inside of the associated inner lead, respectively. This structure exhibits a high strength even though the second face (wire bonding surface) is narrow. Also, Fig. 6b is a cross-sectional view taken with the line C1-C2 of Fig. 6a. The reinforcing tape 160 is attached 15 fixedly so as not to cause twisting in the inner leads. Also, if the inner leads are short in their length, a lead frame fabricated by etching to have a shape shown in Fig. 6a is mounted with the semiconductor chip in accordance 20 with a method as described below. However, where the inner leads are long in their length and have a tendency for the generation of twisting therein, it is impossible to fabricate directly the lead frame by etching to have a shape as shown in Fig. 6a. Therefore, after etching the lead frame in a state where the tips of the inner leads are 25 fixed to the connecting portion 131S as shown in Fig.

6c(i), the inner leads 131 are fixed with the reinforcing tape 160 as shown in Fig. 6c(ii). Then, the connecting portion 131B unnecessary for the fabrication of the resin-encapsulated semiconductor device are removed by means of a press as shown in Fig. 6c (iii), and a semiconductor chip is then mounted on the lead frame. In Fig. 6c(ii), the line E1-E2 shows the line to be cut by a press.

5 A method for the fabrication of the resin-encapsulated semiconductor device will now be described in brief. First, 10 as shown in Fig. 5a, a lead frame, which is fabricated by an etching and from which the unnecessary portions are moved by a cutting process, is arranged in a manner that thin tips of the inner leads are directed upwardly. Moreover, if the inner leads are long in their length, the 15 tips of the inner leads are fixed by a polyimide tape, as required. Then, the surface of the semiconductor device 110 having electrode portions 111 formed thereon is directed downwardly, and located on the inner leads in a manner that the electrode portions are arranged between the 20 inner leads 131. Then, the semiconductor device 110 is mounted fixedly on the inner leads by means of an insulating adhesive 150.

25 Then, as shown in Fig. 5b, the electrode portions are electrically connected to the tips of the inner leads 131 by wires 120. Subsequently, encapsulation is carried out

with the conventional encapsulating resin 140, as shown in Fig. 5c. Such an encapsulation with the resin is carried out using a desired mold in a manner that the outer surface of the terminal columns is somewhat protruded externally 5 from the encapsulating resin. Then, unnecessary portions of the lead frame 130 protruded from the encapsulating resin 140 are cut off by a press to form terminal columns 130 while forming sides 133B of the terminal columns 130, as shown in Fig. 5d. In this case, it is preferable to form 10 previously the cutting line in the lead frame for easy cutting. Particularly, the forming of the cutting line during etching of the lead frame results in the saving of time. The dam bars 136, frame portions 137, etc. of the lead frame 110 as shown in Fig. 6 are removed. Next, 15 terminal portion 133A made of solder is arranged on the outer-surface of each terminal column to fabricate a resin-encapsulated semiconductor device. The terminal portion 133A serves to facilitate connection of the resin-encapsulated semiconductor device to an external circuit, 20 but does not necessarily need to be arranged.

A method for etching the lead frame of the first embodiment will now be described in conjunction with Figs. 8a to 8e. Figs. 8a to 8e are cross-sectional views respectively illustrating sequential steps of the etching process for the lead frame of the first embodiment shown in 25

Fig. 1. In particular, the cross-sectional views of Figs. 8a to 8e correspond to a cross section taken along the line D1 - D2 of Fig. 6a, respectively. In Figs. 8a to 8e, the reference numeral 810 denotes a lead frame blank, 820A and 820B resist patterns, 830 first opening, 840 second openings, 850 first concave portion, 860 second concave portions, 870 flat surface, 880 an etch-resistant layer, 131A tips of inner leads, and 131Ab second faces of inner leads, respectively. First, a water-soluble casein resist is used, using potassium dichromate as a sensitive agent is coated over both surfaces of a lead frame blank 810 made of a 42% nickel-iron alloy and having a thickness of about 0.15 mm. Using desired pattern plates, the resist films are patterned to form resist patterns 820A and 820B having first opening 830 and second openings 840, respectively (Fig. 8a).

The first opening 830 is adapted to etch the lead frame blank 810 to have an etched flat bottom surface of a thickness smaller than that of the lead frame blank 810 in a subsequent process. The second openings 840 are adapted to form desired shapes of tips of inner leads. Although the first opening 830 includes at least an area forming the tips of the inner leads 810, a topology generated by a partially thinned portion by etching in a subsequent process can cause hindrance in a taping process or a

clamping process for fixing the lead frame. Thus, an area to be etched needs to be sufficiently large without being limited to an area for forming the fine portions of the tips of the inner leads. Thereafter, both surfaces of the 5 lead frame blank 810 formed with the resist patterns are etched using a 48% ferric chloride solution of a temperature of 57 °C at a spray pressure of 2.5 kg/cm². The etching process is terminated at the point of time when first recess 850 etched to have a flat etched bottom 10 surface has a depth h corresponding to 2/3 of the thickness of the lead frame blank (Fig. 8b).

Although both surfaces of the lead frame blank 810 are simultaneously etched in the primary etching process, it is unnecessary to simultaneously etch both surfaces of the 15 lead frame blank 810. For instance, an etching process may be conducted at the surface of the lead frame blank formed with the resist pattern 820B having openings of a desired shape to form at least a desired shape of the inner leads using an etchant solution. In this case, the etching 20 process is terminated after obtaining a desired etching depth at the etched inner lead forming regions. The reason why both surfaces of the lead frame blank 810 are simultaneously etched, as in this embodiment, is to reduce the etching time taken in a secondary etching process as 25 described hereinafter. The total time taken for the

primary and secondary etching processes is less than that taken in the case of etching only one surface of the lead frame blank on which the resist pattern 820A is formed.

5 Subsequently, the surface provided with the first recess 850 etched at the first opening 830 is entirely coated with an etch-resistant hot-melt wax (acidic wax type MR-WB6, The Incotec Inc.) by a die coater to form an etch-resistant layer 880 so as to fill up the first recess 850 and to cover the resist pattern 820A (Fig. 8c).

10 It is unnecessary to coat the etch-resistant layer 880 over the entire portion of the surface provided with the resist pattern 820A. However, it is preferred that the etch-resistant layer 880 be coated over the entire portion of the surface formed with the first recess 850 and first opening 830, as shown in Fig. 8c, because it is difficult

15 to coat the etch-resistant layer 880 only on the surface portion including the first recess 850. Although the etch-resistant layer 880 wax employed in this embodiment is an alkali-soluble wax, any suitable wax resistant to the etching action of the etchant solution and remaining somewhat soft during etching may be used. A wax for forming the etch-resistant layer 880 is not limited to the above-mentioned wax, but may be a wax of a UV-setting type.

20 Since the first recess 850 etched by the primary etching process at the surface formed with the pattern adapted to

form a desired shape of the inner lead tip is filled up with the etch-resistant layer 880, it is not further etched in the following secondary etching process. The etch-resistant layer 880 also enhances the mechanical strength of the lead frame blank for the second etching process, thereby enabling the second etching process to be conducted while keeping a high accuracy. It is also possible to enable a second etchant solution to be sprayed at an increased spraying pressure, for example, 2.5 kg/cm² or above, in the secondary etching process. The increased spraying pressure promotes the progress of etching in the direction of the thickness of the lead frame blank in the secondary etching process. Then, the lead frame blank is subjected to a secondary etching process. In this secondary etching process, the lead frame blank 810 is etched at its surface formed with the first recess 850 having a flat etched bottom surface, to completely perforate the lead frame blank 810, thereby forming the tips 890 of the inner leads (Fig. 8d).

The bottom surface 870 of each recess formed by the primary etching process and parallel to the surface of the lead frame is flat. However, both side surfaces of each recess positioned at opposite sides of the bottom surface 870 have a concave shape depressed toward the inside of the inner lead. Then, the lead frame blank is cleaned. After

completion of the cleaning process, the etch-resistant layer 880, and resist films (resist patterns 820A and 820B) are sequentially removed. Thus, a lead frame having a structure of Fig. 6a is obtained in which tips 690 of inner leads are arranged at a fine pitch. The removal of the etch-resistant layer 880 and resist films (resist patterns 820A and 820B) is achieved using a sodium hydroxide solution serving to dissolve them.

The etching method in which the etching process is conducted at two separate steps, respectively, as described above, is generally called a "two-step etching method". This etching method is advantageous in that a desired fineness can be obtained. The etching method used to fabricate the lead frame 130 used in the present invention and shown in Figs. 6a and 6b involves the two-step etching method and the method for forming a desired shape of each lead frame portion while reducing the thickness of each pattern formed. In accordance with the above method, the fineness of the tip 131A of each inner lead formed by this method is dependent on a shape of the second recesses 860 and the thickness of the inner lead tip. For example, where the blank has a thickness t reduced to 50 μ m, the inner leads can have a fineness corresponding to a lead width W_1 of 100 μ m and a tip pitch p of 0.15 mm, as shown in Fig. 6e. In the case of using a small blank thickness t

of about 30 μ m and a lead width W_1 of 70 μ m, it is possible to form inner leads having a fineness corresponding to an inner lead pitch p of 0.12 mm. Of course, it may be possible to form inner leads having a further reduced tip pitch by adjusting the blank thickness t and the lead width W_1 .

5 In the case where twisting of the inner leads does not occur in the fabricating process, as in the case where the inner leads are short in their length, a lead frame illustrated in Fig. 6a can be directly obtained. However, 10 where the inner leads are long in length as compared to those of the first embodiment, the inner leads have a tendency for the generation of twisting. Thus, in this case, the lead frame is obtained by etching in a state where the tips of the inner leads are bound to each other by a connecting member 131B as shown in Fig. 6c(I). Then, 15 the connecting member 131B, unnecessary for the fabrication of a semiconductor package, is cut off by means of a press to obtain a lead frame shaped as shown in Fig. 6a.

20 In the case of fabricating a lead frame 230 having a die pad 235 as shown in Figs. 7a and 7b, the lead frame may be shaped by etching in a state where a connecting member 231B is arranged on the tips of the inner leads to bind the tips directly to the die pad, as shown in Fig. 7c(I). Then, 25 unnecessary portions in the shaped lead frame may be cut

off. Moreover, Fig. 7b is a cross-sectional view taken along the line C11-C22, and the line E11-E21 in Fig. 7c(ii) shows a cutting line. After the inner leads are plated in accordance with a jig plating process, unnecessary portions are cut off to obtain a lead frame having a good quality with no plating failure. Moreover, as described above, where unnecessary portions in the structure shown in Fig. 6c are cut off to obtain the lead frame having a shape shown in Fig. 6a, a reinforcing tape 160 (a polyimide tape) is generally used, as shown in Fig. 6c(iii). Similarly, the reinforcing tape is also used in the case of cutting off unnecessary portions in a structure shown in Fig. 7c. While the connecting member 131B is cut off by means of a press to obtain a shape shown in Fig. 6c(iii), a semiconductor chip is mounted on the lead frame still having the reinforcing tape attached thereon. Also, the mounted semiconductor chip is encapsulated with a resin in a condition where the lead frame still has the tape.

The tip 131A of each inner lead of the lead frame used in the semiconductor device of this first embodiment has a cross-sectional shape as shown in Fig. 9(I). The tip 131A has an etched flat surface (second surface) 131Ab which has a width W_1 slightly more than the width W_2 of an opposite surface. The widths W_1 and W_2 (about 100 μm) are more than the width W at the central portion of the tips when viewed

in the direction of the inner lead thickness. Thus, the tip of the inner lead has a cross-sectional shape having opposite wide surfaces. To this end, although either of the opposite surfaces of the tip 131A can be easily electrically connected to a semiconductor chip (not shown) by a wire 120A or 120B, this embodiment illustrates the use of the etched flat surface for wire-bonding as shown in Fig. 9(ii)a. In Fig. 9, a reference numeral 131Ab depicts an etched flat surface, 131Aa a surface of a lead frame blank, and 121A and 121B, respectively, a plated portion. In the case of Fig. 9(ii)a, there is a particularly excellent wire-bonding property, as the etched flat surface does not have roughness. Fig. 9(iii) shows that the tip 931C of the inner lead of the lead frame fabricated according to the process illustrated in Fig. 10 is wire-bonded to a semiconductor chip. In this case, however, both opposite surfaces of the tip 931C of the inner lead are flat, but have a width smaller than that in a direction of the inner lead thickness. In addition to this, as both the opposite surfaces of the tip 931C are formed of surfaces of the lead frame blank, these surfaces have an inferior wire-bonding property as compared to that of the etched flat surface of the first embodiment. Fig. 9(iv) shows that the inner lead tip 931D or 931E, obtained by thinning in its thickness by a means of a press and then by etching, is wire-bonded to a

semiconductor chip (not shown). In this case, however, a pressed surface of the inner lead tip is not flat as shown Fig. 9(iv). Thus, the wire-bonding on either of the opposite surfaces as shown in Fig. 9(iv)a or Fig. 9(iv)b often results in an insufficient wire-bonding stability and a problematic quality.

5 A modification to the resin-encapsulated semiconductor device of the first embodiment will now be described. Fig. 10 Fig. 2a is a cross-sectional view illustrating a modification to 10 the resin-encapsulated semiconductor device of the first embodiment, and Fig. 2c shows an appearance of the semiconductor device in accordance with the modification. Fig. 2c(ii) is a view when viewed from the bottom of the semiconductor device, Fig. 2c(I) is a front view of the semiconductor device, and Fig. 2b is a cross-sectional view 15 of a terminal column taken at a position corresponding to the line A1-A2 of Fig. 1a. The semiconductor device according to the modification is different with that of the first embodiment in terminal portion 133A. The terminal portions at their tips are protruded externally from a 20 resin 140. The surface of the tip of each terminal portion is plated with solder. Thus, when mounting the resin-encapsulated semiconductor device, the solder is uniformly distributed through an opening 133c. The semiconductor 25 device 100A of this modification is identical to that of

the first embodiment except for the terminal portions 133A. A resin-encapsulated semiconductor device in accordance with a second embodiment will now be described. Fig. 3a is a cross-sectional view of a resin-encapsulated semiconductor device according to the second embodiment, 5 Fig. 3b is a cross-sectional view of an inner lead taken along the line A3-A4 of the Fig. 3a, and Fig. 3c(I) is a cross-sectional view of a terminal column taken along the line A3-A4 of Fig. 3a. In Fig. 3, a reference numeral 200 depicts a resin-encapsulated semiconductor device, 210 a semiconductor chip, 230 a lead frame, 231 inner leads, 10 231Aa a first surface, 231Ab a second surface, 231Ac a third surface, 231Ad a fourth surface, 233 terminal columns, 233A terminal portions, 233B sides, 235 a die pad, 15 240 an encapsulating resin, 250 an insulating adhesive, 250A an adhesive, and 260 a reinforcing tape. In the case of the second embodiment similarly to the case of the first embodiment, the semiconductor chip 210 is mounted in such a manner that the surface, on which electrode portions (pads) 211 are formed, is mounted fixedly on the inner leads 231 by means of the insulating adhesive, while the electrode portions 211 are arranged between the inner leads 231. The electrode portions are electrically connected to the second 20 surfaces 231Ab of the tips of the inner leads 231. The lead frame has the die pad 235 at its inside. The electrode 25 surfaces 231Ab of the tips of the inner leads 231. The lead frame has the die pad 235 at its inside. The electrode

portions 211 are arranged between the inner leads 231 and the die pad 235. Moreover, in the second embodiment similarly to the case of the first embodiment, electrical connection of the semiconductor device 200 to an external circuit is achieved by mounting the semiconductor device 200 on a printed substrate by terminal portions made of a semi-spherical solder and arranged on the tips of the terminal columns 233. In this embodiment, a conductive adhesive is used to adhere the semiconductor chip 210 to the die pad 235, and the die pad 235 and the terminal columns 233 are connected by the inner leads to each other, thereby dissipating heat generated in the semiconductor chip through the die pad. Also, the adhesive 250A necessarily needs to be conductive. However, where the die pad and the semiconductor chip are connected together by means of the conductive adhesive and the die pad is connected to a ground line, it is possible to not only obtain a heat dissipation effect, but also to solve a problem associated with noise.

Similarly to the lead frame used in the first embodiment, the lead frame 230 used in the second embodiment is made of 42% nickel-iron alloy. However, as shown in Figs. 7a and 7b, the lead frame 230 is shaped to have the die pad 235 and the inner leads 233 having a thickness thinner than that of the terminal columns. The

terminal columns each have a thickness of 0.15 mm. The inner leads are arranged at a pitch of 0.12 mm, thereby meeting a demand for the increased terminal number of the semiconductor device. The second surface 231Ab of each 5 inner lead is flat, such that is easy to wire-bond. The third and fourth surfaces 231Ac and 231Ad also have a concave shape depressed toward the inside of the inner lead. This structure exhibits a high strength even though the second face (wire bonding surface) is narrow. Moreover, 10 the fabrication of the resin-encapsulated semiconductor device of the second embodiment is carried out in accordance with substantially the same process as that of the first embodiment.

For example, in a modification to the resin- 15 encapsulated semiconductor device of the second embodiment, an opening 233C is formed on the tip of each terminal column 233 as in the modification to the first-embodiment. The opening is protruded externally from the encapsulating resin 240 such that the tip having the opening serves as 20 the terminal 233A.

A resin-encapsulated semiconductor device in accordance with a third embodiment will now be described. Fig. 4a is a cross-sectional view of a resin-encapsulated semiconductor device in accordance with a third embodiment, 25 and Fig. 4b is a cross-sectional view of an inner lead

taken along the line A5-A6 of Fig. 4a. Also, Fig. 4c(I) is a cross-sectional view of a terminal column taken along the line B5-B6 of Fig. 4a. In Fig. 4, a reference numeral 300 depicts a resin-encapsulated semiconductor device, 310 a semiconductor device, 311 pads, 330 a lead frame, 331 inner leads, 331Aa a first surface, 331Ab a second surface, 331Ac a third surface, 331Ad a fourth surface, 333 terminal columns, 333A terminal portions, 333B sides, 335 a die pad, 340 a encapsulating resin, and 360 a reinforcing resin.

5 Unlike the first or second embodiment above, the semiconductor device 300 in accordance with this third embodiment includes bumps 311. The bumps 311 are mounted fixedly on the inner leads 330 and electrically connect the semiconductor chip 310 and the inner leads 331 together.

10 Similarly to the first or second embodiment, electrical connection of the semiconductor device to an external circuit is achieved by mounting the semiconductor device on a printed substrate by terminal portions 333A made of a semi-spherical solder and arranged on the tips of the

15 terminal columns.

20

Similarly to the lead frame used in the first or second embodiment, the lead frame 330 used in the second embodiment is made of 42% nickel-iron alloy. However, the lead frame 330 is shaped to have the tips 331A of the inner leads having a thickness thinner than that of the terminal

25

columns, as shown in Figs. 6a and 6b. The terminal columns 333 are equal to the lead frame blank in thickness. The tips 331A of the inner leads are 0.015 mm thick, and the remaining portions other than the tips 331A of the inner 5 leads are 0.15 mm thick, such that the lead frame has a strength sufficient to withstand the subsequent processes. The inner leads are arranged at a pitch of 0.12 mm, thereby meeting a demand for the increased terminal number of the 10 semiconductor device. The second surface 331Ab of each inner lead 331A is flat, such that it is easy to wire-bond. The third and fourth surfaces 331Ac and 331Ad also have a concave shape depressed toward the inside of the inner lead. This structure exhibits a high strength even though the second face (wire bonding surface) is narrow. Moreover, 15 the fabrication of the resin-encapsulated semiconductor device of the second embodiment is carried out in accordance with substantially the same process as that of the first embodiment, except that the semiconductor chip is mounted fixedly on the die pad, followed by encapsulation 20 with the encapsulating resin.

For example, in a modification to the resin-encapsulated semiconductor device of the third embodiment, an opening 333C is formed on the tip of each terminal column 333 as in the modification to the first embodiment 25 as shown in Fig. 2. The opening is protruded externally

from the encapsulating resin 340A such that the tip having the opening serves as the terminal 333A.

(EFFECTS OF THE INVENTION)

5 The present invention provides a resin-encapsulated semiconductor device employing the above-mentioned lead frame, which is capable of meeting a demand for the increased terminal number and is excellent in mounting efficiency. Furthermore, the resin-encapsulated
10 semiconductor device in accordance with this invention does not require a process of cutting or bending the dam bars as in the case of using a lead frame having outer leads as shown in Fig. 11b. As a result of this, the resin-encapsulated semiconductor device does not have a problem
15 in that the outer leads are bent, or a problem associated with coplanarity. In addition to these advantages, the resin-encapsulated semiconductor device has a shortened interconnection length as compared to the QTP or the BGA, whereby the semiconductor device can be reduced in a
20 parasitic capacity, and shortened in a transfer delay time.